

09. 2. 2005

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年12月 4日

出願番号 Application Number: 特願2003-405342

[ST. 10/C]: [JP2003-405342]

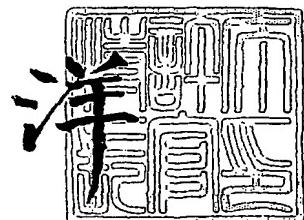
出願人 Applicant(s): 日新イオン機器株式会社

BEST AVAILABLE COPY

2005年 3月 17日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願
【整理番号】 P03017
【提出日】 平成15年12月 4日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01J 37/317
H01L 21/265
C23C 14/48

【発明者】
【住所又は居所】 京都府京都市南区久世殿城町575番地 日新イオン機器株式会社内

【氏名】 内藤 勝男

【特許出願人】
【識別番号】 302054866
【氏名又は名称】 日新イオン機器株式会社
【代表者】 辻 貞夫

【代理人】
【識別番号】 100088661
【弁理士】
【氏名又は名称】 山本 恵二

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 003322
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 0213612

【書類名】特許請求の範囲**【請求項 1】**

イオンビームが入射され当該イオンビームを、一定の走査面内で一定の走査中心を中心にして走査して取り出す走査器と、

この走査器からのイオンビームが入射され当該イオンビームの内の所望エネルギーのイオンビームを、前記走査中心を中心とする円弧状の偏向領域で、前記走査面に垂直な方向に進むように静電的に90度偏向して取り出す静電偏向器とを備えることを特徴とするイオンビーム装置。

【請求項 2】

イオンビームを射出するイオン源と、

このイオン源からのイオンビームが入射され当該イオンビームから所望質量のイオンビームを分離して取り出す質量分離電磁石と、

この質量分離電磁石からのイオンビームが入射され当該イオンビームを、一定の走査面内で一定の走査中心を中心にして走査して取り出す走査器と、

この走査器からのイオンビームが入射され当該イオンビームの内の所望エネルギーのイオンビームを、前記走査中心を中心とする円弧状の偏向領域で、前記走査面に垂直な方向に進むように静電的に90度偏向して取り出す静電偏向器と、

イオン注入すべきターゲットを保持して当該ターゲットを、前記静電偏向器から取り出されたイオンビームに一定の角度で交差する方向に機械的に往復走査する走査機構とを備えることを特徴とするイオンビーム装置。

【請求項 3】

前記走査機構は、前記ターゲットをその表面に平行に走査するものである、請求項2に記載のイオンビーム装置。

【請求項 4】

前記静電偏向器は、間隔をあけて相対向する一対の偏向電極を有している、請求項1ないし3のいずれかに記載のイオンビーム装置。

【請求項 5】

一点で互いに直交する三つの軸をX軸、Y軸およびZ軸としたとき、

前記走査器に入射するイオンビームは、Z軸に平行に前記走査器に入射するものあり

前記走査器は、前記入射されたイオンビームをY-Z平面に平行な前記走査面内で前記走査中心を中心にして走査するものであり、

前記静電偏向器は、前記入射されたイオンビームの内の所望エネルギーのイオンビームを90度偏向させてX軸に平行に出射するものあり、

前記走査かつ偏向されたイオンビームの内で所望エネルギーを有するイオンビームの1本のイオンビームの軌道を考えたとき、当該軌道は、直線部の先端に、X軸に平行になるように弧状に90度曲がった弧状部を有しており、

前記静電偏向器を構成する一対の偏向電極の相対向面は、それぞれ、前記1本のイオンビームの軌道を前記走査中心を通りX軸に平行な軸を中心にして前記走査方向に所定角度回転させたときに前記弧状部が描く回転面に概ね沿う形状をしている、請求項4に記載のイオンビーム装置。

【請求項 6】

前記偏向電極を構成する一対の偏向電極の相対向面は、それぞれ、トーラスを、前記走査中心を通りX軸に平行なトーラス中心軸を中心とする円周方向に所定角度だけ切り取り、かつトーラスの縦断面の外周が形成する円弧を90度だけ切り取った形状をしている、請求項5に記載のイオンビーム装置。

【請求項 7】

前記偏向電極を構成する一対の偏向電極の相対向面は、それぞれ、前記回転面に概ね沿う複数の面を組み合わせて形成されている、請求項5または6に記載のイオンビーム装置。

【請求項 8】

前記静電偏向器を構成する一対の偏向電極の内の少なくとも一方は、偏向角の増大方向に隙間をあけて複数に分割されている、請求項 4 ないし 7 のいずれかに記載のイオンビーム装置。

【請求項 9】

前記静電偏向器を構成する一対の偏向電極の少なくとも相対向面は、それぞれ、カーボンで形成されている、請求項 4 ないし 8 のいずれかに記載のイオンビーム装置。

【請求項 10】

前記静電偏向器を構成する一対の偏向電極に、直流電圧であつて接地電位に対して対称の偏向電圧をそれぞれ印加する偏向電源を備えている、請求項 4 ないし 9 のいずれかに記載のイオンビーム装置。

【請求項 11】

前記走査器は、それに入射するイオンビームをその入射軸に対して対称に走査するものである、請求項 1 ないし 10 のいずれかに記載のイオンビーム装置。

【請求項 12】

前記走査器は、それに入射するイオンビームをその入射軸に対して片側方向においてのみ走査するものである、請求項 1 ないし 10 のいずれかに記載のイオンビーム装置。

【請求項 13】

前記走査器と静電偏向器との間に設けられていて前記走査されたイオンビームを静電的に加速または減速する加減速器を備えており、

この加減速器はイオンビームの進行方向に一定の間隔をあけて配置された少なくとも 2 枚の電極を有しております、

この各電極は、前記走査中心を中心とする円弧状をしており、かつ、前記走査されたイオンビームの走査方向の幅よりも幅の広いビーム通過穴を有している、請求項 1 ないし 12 のいずれかに記載のイオンビーム装置。

【請求項 14】

前記加減速器を構成する入口の電極が、所望質量のイオンビームを通過させ不所望質量のイオンを阻止する分析スリットを兼ねている、請求項 13 に記載のイオンビーム装置。

【請求項 15】

前記静電偏向器の出口付近に、所望エネルギーのイオンビームを通し不所望エネルギーのイオンを阻止するビームマスクを設けている、請求項 1 ないし 14 のいずれかに記載のイオンビーム装置。

【請求項 16】

前記静電偏向器を出たイオンビームの、その進行方向に垂直な走査ビーム断面の形状は弧状をしており、前記ビームマスクは、この弧状の走査ビーム断面にはほぼ相似形の弧状のビーム通過穴を有している、請求項 15 に記載のイオンビーム装置。

【請求項 17】

前記走査器は互いに平行な一対の走査電極を有しております、この一対の走査電極間に、

$$V_s = c t / (1 - c^2 t^2)^{1/2}, \quad (c \text{ は定数, } t \text{ は時間})$$

で表される走査電圧 V_s を印加する走査電源を備えている、請求項 1 ないし 16 のいずれかに記載のイオンビーム装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】イオンビーム装置

【技術分野】

【0001】

この発明は、ターゲットにイオンビームを照射してイオン注入を行うイオン注入装置ならびに当該イオン注入装置を構成するものであってイオンビームの走査および偏向を行なうイオンビーム偏向装置等を包含した概念のイオンビーム装置に関し、より具体的には、イオンビームのビームライン長を短くすることを可能にしたイオンビーム装置に関する。

【背景技術】

【0002】

イオン注入装置のようなイオンビーム装置（以下、イオン注入装置で代表する。）においては、従来から、ターゲット（例えば半導体基板）の面内においてイオンビームの入射角を均一にするために、イオンビームの平行化が行われている。

【0003】

また、ターゲットに、所望エネルギーのイオンと共に、不所望エネルギーのイオン（これを、「エネルギー汚染物質」または「エネルギーcontresante」と言う。）が注入されること（これを、「エネルギー汚染」または「エネルギーcontresante」）と/or）を防止するために、不所望エネルギーのイオンの除去（これを、「エネルギー分離」または「エネルギー分析」と言う。）が行われている。

【0004】

上記のイオンビームの平行化とエネルギー分離とは、従来は、別々の機能要素によって行われていた。

【0005】

このため、イオンビームのビームライン長が長くなり、イオンビームの発散等による損失が大きくなり、ビーム輸送効率の低下を招き、十分なビーム量を確保することが難しいという課題があった。特に、低エネルギーでのイオンビームの輸送においては、イオンビームの空間電荷効果が顕著に現れてイオンビームが発散してその効率の良い輸送が困難になるので、ビームライン長をできるだけ短くすることが可能なイオン注入装置が望まれていた。

【0006】

従来技術の具体例を挙げると、特許文献1には、静電偏向によるエネルギー分離技術が記載されている。しかし、ここでエネルギー分離に用いられている静電偏向電極は、平行平板型の電極であって、イオンビームはその静電偏向電極によって平行化されるものではない。イオンビームの平行化には、平行化のためだけに設けられた別の平行平板型の走査電極によって行われている。従って、前述したようにビームライン長が長くなるという課題がある。

【0007】

他のエネルギー分離技術としては、最終エネルギーにまでイオンビームが加速された後に（即ち下流側に）偏向電磁石を配置して、そこでのイオンビームの旋回半径 R_1 が次式で決まることを用いるものがある。ここで、Bは磁束密度、mはイオンビームを構成するイオンの質量、qは電荷、 V_1 はイオンビームの加速電圧でありエネルギーに相当する。

【0008】

[数1]

$$R_1 = (1/B) \times (2mV_1/q)^{1/2}$$

【0009】

このような技術は、例えば特許文献2にエネルギー分析マグネットとして記載されている。しかし、ここで用いられている技術は、走査も平行化も行われていないイオンビームに対して行われるものであり、イオンビームの平行化には、平行化のためだけに設けられた別のビーム平行化マグネットと名付けられた偏向電磁石によって行われている。従って

前述したようにビームライン長が長くなるという課題がある。

【0010】

これに対して、走査されたイオンビームに対しての平行化とエネルギー分離とを一つの要素（扇型電磁石）によって行う技術が、特許文献3に記載されている。

【0011】

【特許文献1】特開平3-233845号公報（第1頁右欄～第2頁左上欄、第6図）

【特許文献2】特許第3358336号公報（段落0002、0003、図1）

【特許文献3】特開平11-354064号公報（段落0016～0018、図1）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

上記特許文献3に記載の技術は、イオンビームの平行化とエネルギー分離とを、扇型電磁石と名付けられた偏向電磁石を用いて行うものであるので、イオンビームのエネルギー（数1のV₁に相当）および所望イオンの質量mが大きくなると、例えば200keV以上のエネルギーのインジウム（In）イオンを取り出そうとすると、前記数1からも分かるように、一定の旋回半径R₁を実現するためには、磁束密度Bを非常に大きくしなければならず、そのためには偏向電磁石を構成する鉄心およびコイルが非常に大きくなり、偏向電磁石が巨大化する。また、偏向電磁石の重量やコスト、偏向電磁石用の電源等も大きくなるという課題がある。

【0013】

しかも、特許文献3に記載の技術は、静電偏向器と名付けられた走査器によってイオンビームが走査されている面内でイオンビームが偏向電磁石によって偏向されるので、偏向電磁石におけるイオンビームの偏向角を非常に大きくしないと、エネルギー分離が十分に行えず、不所望エネルギーイオンの除去が十分に行えないという課題がある。これは、所望エネルギーのイオンビームも不所望エネルギーのイオンも走査器によって走査されて広がっているので、この広がったもの同士を同一面内で互いに分離するためには、細いイオンビームを分離する場合と違って、あるいは異なった面内で分離する場合と違って、イオンビームの偏向角を非常に大きくしなければならないからである。偏向角を非常に大きくするということは、前記数1に示した磁束密度Bを非常に大きくして旋回半径R₁を非常に小さくすることであり、その場合には前記と同様の課題がある。

【0014】

偏向電磁石における偏向角をあまり大きくせずに、不所望エネルギーのイオンがターゲットに入射する課題を解決しようとすると、偏向電磁石出口からターゲットまでの距離を大きくしなければならず、その結果、ビームライン長が長くなるという課題が生じる。

【0015】

更に、偏向電磁石の中やその上下側で、イオンビームと雰囲気中に残留している分子とが衝突する等によって生じた中性粒子は偏向電磁石中を直進するため、偏向電磁石における偏向角を大きくするかまたは偏向電磁石からターゲットまでの距離を大きくしないと、直進した中性粒子がターゲットに入射し、それによってターゲットに対する注入不均一性が生じる。これを解決するためには、偏向電磁石における偏向角を大きくすることと、偏向電磁石出口からターゲットまでの距離を大きくすることの少なくとも一方を採用しなければならず、いずれにしても、やはり、ビームライン長が長くなるという課題がある。

【0016】

そこでこの発明は、イオンビームの平行化およびエネルギー分離を行うことができ、しかもイオンビームのビームライン長を短くすることを可能にしたイオンビーム装置を提供することを主たる目的としている。

【課題を解決するための手段】

【0017】

この発明に係るイオンビーム装置の一つは、イオンビームが入射され当該イオンビーム

を、一定の走査面内で一定の走査中心を中心にして走査して取り出す走査器と、この走査器からのイオンビームが入射され当該イオンビームの内の所望エネルギーのイオンビームを、前記走査中心を中心とする円弧状の偏向領域で、前記走査面に垂直な方向に進むよう静電的に90度偏向して取り出す静電偏向器とを備えることを特徴としている。このイオンビーム装置は、イオンビームの走査および偏向を行う構成であるので、イオンビーム偏向装置と呼ぶこともできる。

【0018】

この発明に係る他のイオンビーム装置は、イオンビームを射出するイオン源と、このイオン源からのイオンビームが入射され当該イオンビームから所望質量のイオンビームを分離して取り出す質量分離電磁石と、この質量分離電磁石からのイオンビームが入射され当該イオンビームを、一定の走査面内で一定の走査中心を中心にして走査して取り出す走査器と、この走査器からのイオンビームが入射され当該イオンビームの内の所望エネルギーのイオンビームを、前記走査中心を中心とする円弧状の偏向領域で、前記走査面に垂直な方向に進むよう静電的に90度偏向して取り出す静電偏向器と、イオン注入すべきターゲットを保持して当該ターゲットを、前記静電偏向器から取り出されたイオンビームに一貫して交差する方向に機械的に往復走査する走査機構とを備えることを特徴としている。このイオンビーム装置は、イオンビームの走査、偏向およびターゲットへの入射等を行う構成であるので、イオン注入装置と呼ぶこともできる。

【0019】

上記イオンビーム装置によれば、走査器によって走査されたイオンビームは、扇状に広がって静電偏向器に入射する。

【0020】

静電偏向器に入射したイオンビームの内の所望エネルギーのイオンビームは、前記走査中心を中心とする円弧状の偏向領域で、前記走査面に垂直な方向に進むよう静電的に90度偏向されて、静電偏向器から取り出される（出射する）。

【0021】

このようにして静電偏向器から取り出された所望エネルギーのイオンビームを構成する1本1本のイオンビームは、互いに平行である。これは、一つの面に立てた複数本の垂線が互いに平行であるのと同様に、一つの走査面に垂直に出射する各イオンビームは、その走査位置に拘わらず、互いに平行であるからである。このようにして、静電偏向器から出射するイオンビームの平行化を行うことができる。

【0022】

静電偏向器に入射したイオンビームの内の不所望エネルギーのイオンは、所望エネルギーのイオンビームとは偏向半径（旋回半径）が異なるので、所望エネルギーのイオンビームから分離される。このようにして、エネルギー汚染物質の除去、即ちエネルギー分離を行ふことができる。

【0023】

しかも、静電偏向器におけるイオンビームの偏向方向は、走査器におけるイオンビームの走査方向とは垂直方向であり、特許文献3に記載されている技術と違って、走査器によって走査されて広がったエネルギーの異なるイオンビーム同士を同一面内で互いに分離するのではなく異なった面内で互いに分離するので、異エネルギーイオンの分離は容易である。従ってエネルギー分離機能は非常に大きい。加えて、静電偏向器におけるイオンビームの偏向角度が90度と大きいので、この観点からも、異エネルギーイオンの分離は容易であり、従ってエネルギー分離機能は非常に大きい。この両者が相俟って、静電偏向器におけるエネルギー分離機能は極めて大きい。

【0024】

また、静電偏向器の場合は、偏向電磁石の場合と違って、偏向角度を大きくすることは、当該静電偏向器を曲げること等によって比較的簡単に実現することができるので、しかも偏向角度はイオンの質量に依存せず大きな質量のイオンを偏向することも容易である。偏向角度を90度と大きくしても、特許文献3に記載されている偏向電磁石が有する

前記巨大化等の課題発生を避けることができる。

【0025】

上記のように、この発明に係るイオンビーム装置によれば、一つの静電偏向器によって、イオンビームの平行化とエネルギー分離の両方を行うことができるので、両者を特許文献1または2に記載の技術のように別々の機能要素によって行う場合に比べて、イオンビームのビームライン長を短くすることができる。

【0026】

更に、上記のように静電偏向器におけるエネルギー分離機能は極めて大きいので、特許文献3に記載の技術に比べて、静電偏向器出口からターゲットまでの距離を大幅に短くすることができる。従ってこの観点からも、イオンビームのビームライン長を短くすることができます。

【0027】

前記走査機構は、前記ターゲットをその表面に平行に走査するものであっても良い。

【0028】

前記静電偏向器は、例えば、間隔をあけて相対向する一対の偏向電極を有している。

【0029】

一点で互いに直交する三つの軸をX軸、Y軸およびZ軸としたとき、例えば、前記走査器に入射するイオンビームは、Z軸に平行に前記走査器に入射するものであり、前記走査器は、前記入射されたイオンビームをY-Z平面に平行な前記走査面内で前記走査中心を中心にして走査するものであり、前記静電偏向器は、前記入射されたイオンビームの内之所望エネルギーのイオンビームを90度偏向させてX軸に平行に出射するものであり、前記走査かつ偏向されたイオンビームの内で所望エネルギーを有するイオンビームの1本のイオンビームの軌道を考えたとき、当該軌道は、直線部の先端に、X軸に平行になるよう弧状に90度曲がった弧状部を有しており、前記静電偏向器を構成する一対の偏向電極の相対向面は、それぞれ、前記1本のイオンビームの軌道を前記走査中心を通りX軸に平行な軸を中心にして前記走査方向に所定角度回転させたときに前記弧状部が描く回転面に概ね沿う形状をしている。

【0030】

前記偏向電極を構成する一対の偏向電極の相対向面は、それぞれ、トーラスを、前記走査中心を通りX軸に平行なトーラス中心軸を中心とする円周方向に所定角度だけ切り取り、かつトーラスの縦断面の外周が形成する円弧を90度だけ切り取った形状をしていても良い。

【0031】

前記偏向電極を構成する一対の偏向電極の相対向面は、それぞれ、前記回転面に概ね沿う複数の面を組み合わせて形成されていても良い。

【0032】

前記静電偏向器を構成する一対の偏向電極の内の少なくとも一方は、偏向角の増大方向に隙間をあけて複数に分割されていても良い。

【0033】

前記静電偏向器を構成する一対の偏向電極の少なくとも相対向面は、それぞれ、カーボンで形成されていても良い。

【0034】

前記静電偏向器を構成する一対の偏向電極に、直流電圧であって接地電位に対して対称の偏向電圧をそれぞれ印加する偏向電源を備えていても良い。

【0035】

前記走査器は、それに入射するイオンビームをその入射軸に対して対称に走査するものであっても良いし、当該イオンビームをその入射軸に対して片側方向においてのみ走査するものであっても良い。

【0036】

前記走査器と静電偏向器との間に設けられていて前記走査されたイオンビームを静電的

に加速または減速する加減速器を更に備えていて、この加減速器はイオンビームの進行方向に一定の間隔をあけて配置された少なくとも2枚の電極を有していて、この各電極は、前記走査中心を中心とする円弧状をしていると共に、前記走査されたイオンビームの走査方向の幅よりも幅の広いビーム通過穴を有していても良い。

【0037】

前記静電偏向器の出口付近に、所望エネルギーのイオンビームを通し不所望エネルギーのイオンを阻止するビームマスクを設けても良い。

【0038】

前記静電偏向器を出たイオンビームの、その進行方向に垂直な走査ビーム断面の形状は弧状をしており、前記ビームマスクは、この弧状の走査ビーム断面にはほぼ相似形の弧状のビーム通過穴を有していても良い。

【0039】

前記走査器は互いに平行な一对の走査電極を有していて、この一对の走査電極間に、 $V_s = c t / (1 - c^2 t^2)^{1/2}$ 、(cは定数、tは時間)で表される走査電圧Vsを印加する走査電源を備えていても良い。

【発明の効果】

【0040】

以上のようにこの発明によれば、一つの静電偏向器によって、イオンビームの平行化とエネルギー分離の両方を行うことができるので、両者を別々の機能要素によって行う場合に比べて、イオンビームのビームライン長を短くすることができる。

【0041】

更に、上記のように静電偏向器におけるエネルギー分離機能は極めて大きいので、公知の偏向電磁石を用いる場合に比べて、静電偏向器出口からターゲットまでの距離を大幅に短くすることができる。従ってこの観点からも、イオンビームのビームライン長を短くすることができる。

【0042】

その結果、例えば、イオンビームの発散等による損失を低減してビーム輸送効率の向上を図り、大きなビーム量を確保することが可能になる。この効果は、特に低エネルギーのイオンビームを輸送する場合に顕著になる。

【0043】

また、ビームライン長を短くすることができるので、装置全体をコンパクトにすることができる。

【0044】

また、イオンビームの平行化およびエネルギー分離を行う静電偏向器は、磁場を用いる偏向電磁石に比べて、軽量化および低消費電力化が可能である。

【0045】

請求項3に記載の発明によれば、ターゲットへのイオンビームの注入角が0度でない場合でも、ターゲットに入射するイオンビームのビーム進行方向における入射位置が、ターゲット面内において変化せず一定である、という更なる効果を奏する。

【0046】

請求項8に記載の発明によれば、分割した偏向電極間の隙間から静電偏向器内を効率良く真空排気することができる、という更なる効果を奏する。

【0047】

請求項9に記載の発明によれば、不所望エネルギーのイオンが偏向電極の相対向面に衝突してスパッタしても、スパッタ粒子はカーボンをスパッタして生じるものであるので、これが万ーターゲットに到達しても、ターゲット表面に作成される半導体デバイスの特性に与える影響が少ない、という更なる効果を奏する。

【0048】

請求項10に記載の発明によれば、次のような更なる効果を奏する。即ち、所望エネルギーのイオンビームは静電偏向器内において接地電位部付近を通過することになるので、

静電偏向器の中で当該イオンビームが加減速されない。また、静電偏向器のすぐ上流側の機器およびすぐ下流側の機器は通常は接地電位であるので、静電偏向器の前後においてもイオンビームが加減速されない。従って、静電偏向器を通してイオンビームのエネルギーが変化しない。

【0049】

請求項12に記載の発明によれば、中性粒子は走査器において走査されずに直進するので、中性粒子とイオンビームとの分離が容易になる、という更なる効果を奏する。

【0050】

請求項13に記載の発明によれば、加減速器中の電界は、走査器によって走査されたイオンビームの走査位置に拘わらず常に、加減速器に入射するイオンビームの方向に平行に加わるので、走査されたイオンビームを電界によって加速または減速しても、当該電界によってイオンビームは曲げられずイオンビームの方向が変わらない、という更なる効果を奏する。

【0051】

請求項14に記載の発明によれば、分析スリットを別個に設けなくて済むので、分析スリットを別個に設ける場合に比べて、ビームライン長を短くすることができる、という更なる効果を奏する。

【0052】

請求項15に記載の発明によれば、静電偏向器とビームマスクとが協働して、エネルギー分離性能を高めることができる、という更なる効果を奏する。

【0053】

請求項16に記載の発明によれば、静電偏向器とビームマスクとが協働して、エネルギー分離性能をより一層高めることができる、という更なる効果を奏する。

【0054】

請求項17に記載の発明によれば、静電偏向器を出たイオンビームの、走査方向における直線上の走査速度が一定になる、という更なる効果を奏する。

【発明を実施するための最良の形態】

【0055】

図1は、この発明に係るイオンビーム装置（より具体的にはイオン注入装置）の一実施形態を示す平面図である。図2は、図1のイオンビーム装置を矢印F方向に見て部分的に示す正面図であり、イオン源から静電偏向器の出口までを示す。なお、以下において、イオン源2から射出されたイオンビーム4の進行経路において、イオン源に近い側を「上流側」、その反対側を「下流側」という。

【0056】

このイオンビーム装置は、イオンビーム4を射出するイオン源2と、このイオン源2からのイオンビーム4が入射され当該イオンビーム4から所望質量のイオンビーム4を分離して取り出す（即ち質量分離を行う）質量分離電磁石6と、この質量分離電磁石6からのイオンビーム4が入射され当該イオンビーム4を、一定の走査面13（図3参照）内で一定の走査中心Pを中心にして走査して取り出す走査器12とを備えている。この走査器12によるイオンビーム4の走査角度をθとする。

【0057】

この実施形態では、一点で互いに直交する三つの軸をX軸、Y軸およびZ軸としたとき、走査器12に入射するイオンビーム4は、Z軸に平行に入射するものであり、走査器12は、当該入射されたイオンビーム4をY-Z平面に平行な前記走査面13内で前記走査中心Pを中心にして走査するものである。

【0058】

図1以降の各図中には、イオンビーム4の進行方向、各機器の向き等の理解を容易にするため、X軸、Y軸およびZ軸を図示している。

【0059】

イオン源2から射出されるイオンビーム4は、断面（進行方向に直交する断面）が例え

ば円形のスポット状をしているが、他の（例えば橢円形や長方形等の）断面形状でも良い。

【0060】

質量分離電磁石6と走査器12との間には、必要に応じて、この例のように、イオンビーム4の断面形状を整形する四重極レンズ（Qレンズ）8を設けても良い。

【0061】

質量分離電磁石6の下流側には、通常は、この例のように、質量分離電磁石6と協働して、所望質量のイオンビーム4を通過させ不所望質量のイオンを阻止する（即ち質量分離を行う）分析スリット10が設けられる。この分析スリット10は、この例では走査器12のすぐ上流側に設けているが、後述する加減速器22の入口（最上流側）の電極24のすぐ上流側に配置しても良いし、当該入口の電極24に分析スリットを兼ねさせてても良い。兼ねさせると、分析スリットを別個に設けなくて済むので、分析スリットを別個に設ける場合に比べて、ビームライン長を短くすることができる。

【0062】

上記イオン源2から走査器12までの各機器は、この実施形態では、高電圧ボックス18内に収納されている。この高電圧ボックス18は、図2に示すように、接地電位部21から支持碍子20によって支持されている。この高電圧ボックス18およびそれに接続された加減速器22の前記入口の電極24と接地電位部21との間には、直流電源である加減速電源28から、加減速電圧 V_A が印加される。加減速電源28は、加減速器22によってイオンビーム4を加速する加速モードの場合は図示例のように高電圧ボックス18側を正極側にして接続され、減速する減速モードの場合は図示例とは反対に高電圧ボックス18側を負極側にして接続される。加速モードの場合に使用する加減速電源28と減速モードの場合に使用する加減速電源28とは、互いに同一の電源でも良いし、別の電源でも良い。あるいは、減速モードの場合は、イオン源2と大地電位部21との間に減速モード専用電源（図示せず）を入れ、これによって、イオンビーム4を加減速器22で減速させても良い。

【0063】

走査器12は、この実施形態では、互いに平行な一対の平行平板型の走査電極14を有する静電型のものであり、両走査電極14間には、走査電源16から、三角波状または概ね三角波状をした走査電圧 V_s （例えば図15参照）が印加される。より具体的には、この例では、高電圧ボックス18の電位を基準にしてそれよりも高電圧側および低電圧側に対称に振動する走査電圧 V_s が印加される。即ち、 $\pm V_s$ が印加される。

【0064】

走査器12は、当該走査器12に入射するイオンビーム4を、図2、図3等に示す例のように、その入射軸（即ち、Z軸に平行な軸）62に対して対称に走査するものでも良いし、入射軸62に対して片側（Y軸方向における片側）方向においてのみ走査するものでも良い。後者のように走査するためには、例えば、走査電圧 V_s の中心電位を、高電圧ボックスの電位よりも高い方または低い方に片寄らせて、バイアスをかけなければ良い。後者のように走査すると、中性粒子は走査器12において走査されずに直進するので、中性粒子とイオンビーム4との分離が容易になる。

【0065】

このイオンビーム装置は、更に、走査器12からのイオンビーム4が入射され当該イオンビーム4の内の所望エネルギーのイオンビーム4aを、前記走査中心Pを中心とする円弧状の偏向領域で、前記走査面13に垂直な方向に、即ちX軸に平行な方向に進むように静電的に90度偏向して取り出す静電偏向器30と、イオン注入すべきターゲット（例えば半導体基板）50を保持して当該ターゲット50を、静電偏向器30から取り出されたイオンビーム4aに一定の角度で交差する方向に機械的に往復走査する走査機構54とを備えている。ターゲット50は、この例ではホルダ52に保持される。

【0066】

走査器12と静電偏向器30との間には、この実施形態のように、走査器12によって

走査されたイオンビーム4を静電的に加速または減速する加減速器22を設けても良い。この加減速器22は、イオンビーム4の進行方向に一定の間隔をあけて配置された少なくとも2枚の電極24を有しており、この各電極24は、図3も参照して、前記走査中心Pを中心とする円弧状をしており、かつ、走査されたイオンビーム4の走査方向の幅よりも幅の広いビーム通過穴26を有している。

【0067】

この加減速器22を構成する各電極24の電位は、この実施形態では、入口の電極24の電位は高電圧ボックス18と同電位であり、出口（最下流側）の電極24の電位は接地電位であり、両者の間の電極24の電位は両者の間の電位である。

【0068】

上記のような加減速器22を用いれば、加減速器22中の電界は、走査器12によって走査されたイオンビーム4の走査位置に拘わらず常に、加減速器22に入射するイオンビーム4の方向に平行に加わるので、走査されたイオンビーム4を電界によって加速または減速しても、当該電界によってイオンビーム4は曲げられずイオンビーム4の進行方向が変わらない。

【0069】

上記静電偏向器30について、図3等も参照して更に説明する。

【0070】

静電偏向器30は、所定の間隔をあけて相対向する一対（一組）の偏向電極32を有している。

【0071】

静電偏向器30は、前述したように、入射されたイオンビーム4の内の所望エネルギーのイオンビーム4aを90度偏向させてX軸に平行に出射するものであり、走査器12によって走査されかつ静電偏向器30によって偏向されたイオンビーム4の内で所望エネルギーを有するイオンビーム4aの1本のイオンビーム4aの軌道を考えたとき、当該軌道は、直線部の先端に、X軸に平行になるように弧状に90度曲がった弧状部を有しており、静電偏向器30を構成する一対の偏向電極32の相対向面33は、それぞれ、前記1本のイオンビーム4aの軌道を前記走査中心Pを通りX軸に平行な軸60を中心にして前記走査方向に所定角度回転させたときに前記弧状部が描く回転面に沿う、または概ね沿う形状をしている。

【0072】

各偏向電極32の相対向面33と反対側の面の形状は、特定のものに限定されない。例えば、図1等に示す例のように相対向面33に沿う形状をしていても良いし、それ以外の形状でも良い。なぜなら、イオンビーム4を偏向する電界は、各相対向面33間に形成されるので、相対向面33の形状が重要だからである。

【0073】

この静電偏向器30におけるイオンビーム4の偏向位置は、走査器12によってどの角度に走査されているイオンビーム4に対しても、走査中心Pから等距離の所である。また、偏向力が働く方向は、各走査イオンビーム4に対して、その走査イオンビーム4の向かう方向を含み、走査面13とは垂直な面内にある。即ち、この静電偏向器30の構成は、より具体的には、その相対向面33の構成は、イオンビーム4の走査角度θに対しての対称性（方位角方向の対称性）を有するものである。

【0074】

静電偏向器30の両偏向電極32の相対向面33間の空間は、イオンビーム4が入射する入口端面36、所望エネルギーのイオンビーム4aを90度偏向する偏向領域34およびイオンビーム4aが出射する出口端面38から成り、入口端面36は、イオンビーム4の走査面13に対して、即ちY-Z平面に対して垂直であり、かつ前記走査中心Pを中心とする円弧状に曲がっている。出口端面38は、Y-Z平面に平行であり、かつ前記走査中心Pを当該出口端面38を含む平面上に投影した点を中心とする円弧状に曲がっている。偏向領域34は、イオンビーム4のどの走査角度θにおいても同じ曲がり方で曲がって

、入口端面36と出口端面38との間をつないでいる。

【0075】

例えば、図1～図3に示す偏向電極30を構成する各偏向電極32の相対向面33は、それぞれ、図4に示すようなトーラス95を、前記走査中心Pを通りX軸に平行なトーラス中心軸96を中心とする円周方向に所定角度だけ切り取り、かつトーラス95の縦断面(ポロイダル断面)98の外周が形成する円弧を90度だけ切り取ってできる、点e、f、g、hで囲まれる曲面100と同一形状またはそれに沿う形状をしている。

【0076】

静電偏向器30を構成する一対の偏向電極32間には、外側の偏向電極32から内側の偏向電極32に向かう電界を形成して、イオンビーム4を上記のように偏向させる直流の偏向電圧が偏向電源から印加される。

【0077】

この場合、偏向電源は、単純に外側の偏向電極32に内側の偏向電極32よりも高い偏向電圧を印加するもの、例えば後者32を接地電位にして前者32に正の偏向電圧を印加するものでも良いけれども、この実施形態のように、外側と内側の偏向電極32に、接地電位に対して対称の(即ち、絶対値が同じで極性が正負反対の)偏向電圧 $+V_D$ 、 $-V_D$ をそれぞれ印加する偏向電源40a、40bを設けるのが好ましい。

【0078】

そのようにすると、両偏向電極32の相対向面33の中間が接地電位になる。その結果、所望エネルギーのイオンビーム4aは静電偏向器30内において接地電位部付近を通過することになるので、静電偏向器30の中で当該イオンビーム4aが加減速されない。また、静電偏向器30のすぐ上流側の機器およびすぐ下流側の機器は通常は接地電位であるので、例えば前述した加減速器22の出口の電極24は接地電位であり、ホルダ52や後述するビームマスク46等も接地電位であるので、静電偏向器30の前後においてもイオンビーム4、4aが加減速されない。従って、静電偏向器30を通してもイオンビームのエネルギーが変化しない。

【0079】

このイオンビーム装置によれば、走査器12によって走査されたイオンビーム4は、扇状に広がって静電偏向器30に入射する。

【0080】

静電偏向器30に入射したイオンビーム4内の所望エネルギーのイオンビーム4aは、前記走査中心Pを中心とする円弧状の偏向領域34で、前記走査面13に垂直な方向に進むように静電的に90度偏向されて、静電偏向器30から取り出される(出射する)。

【0081】

このようにして静電偏向器30から取り出された所望エネルギーのイオンビーム4aを構成する1本1本のイオンビーム4aは、互いに平行である。この実施形態では、X軸に平行な状態で互いに平行である。その様子の例を、図9、図11、図17(A)等に示す。これは、一つの面に立てた複数本の垂線が互いに平行であるのと同様に、一つの走査面13に垂直に出射する各イオンビーム4aは、その走査位置に拘わらず、互いに平行であるからである。このようにして、静電偏向器30から出射するイオンビーム4aの平行化を行うことができる。

【0082】

静電偏向器30に入射したイオンビーム4内の不所望エネルギーのイオン4bは、所望エネルギーのイオンビーム4aとは偏向半径(旋回半径)が異なるので、図1中に例示するように、所望エネルギーのイオンビーム4aから分離される。このようにして、エネルギー汚染物質の除去、即ちエネルギー分離を行うことができる。

【0083】

しかも、静電偏向器30におけるイオンビーム4の偏向方向は、走査器12におけるイオンビーム4の走査方向とは垂直方向であり、特許文献3に記載されている技術と違って

、走査器12によって走査されて広がったエネルギーの異なるイオンビーム同士を同一面内で互いに分離するのではなく異なった面内で互いに分離するので、異エネルギーイオンの分離は容易であり、従ってエネルギー分離機能は非常に大きい。加えて、静電偏向器30におけるイオンビーム4aの偏向角度が90度と大きいので、この観点からも、異エネルギーイオンの分離は容易であり、従ってエネルギー分離機能は非常に大きい。この両者が相俟って、静電偏向器30におけるエネルギー分離機能は極めて大きい。

【0084】

また、静電偏向器30の場合は、偏向電磁石の場合と違って、偏向角度を大きくすることは、当該静電偏向器30を曲げること等によって比較的簡単に実現することができるのでは、しかも偏向角度はイオンビームを構成するイオンの質量mに依存せず大きな質量mのイオンを偏向することも容易であるので、偏向角度を90度と大きくしても、特許文献3に記載されている偏向電磁石が有する前記巨大化等の課題発生を避けることができる。

【0085】

静電偏向器30における偏向角度がイオンの質量mに依存しないことを説明する。一般的に、平行平板型の偏向電極を用いた静電偏向による偏向角度θは、入射イオンビームのエネルギーをE_B、そのイオンビームを構成するイオンの電荷をq、偏向電極間に印加される偏向電圧をV、偏向経路長をlとすると、次式で表される。

【0086】

[数2]

$$\tan \theta = k V L q / E_B, \quad (k \text{ はイオンの質量に依らない定数})$$

【0087】

また、円筒面状の偏向電極を用いて、イオンビームの偏向軌道が円を描くような静電偏向のときは、上記数2において $\tan \theta$ を θ [ラジアン] と置き換えて表現される。

【0088】

上記式から明らかなように、静電偏向による偏向角度θは、磁場偏向の場合（前記数1参照）と違って、イオンビームを構成するイオンの質量mに依存しない。静電偏向器30の場合も同様である。従って、大きな質量mのイオンに対するエネルギー分離を行う場合でも、質量mに応じて偏向電圧Vを大きくする必要はないので、偏向電源の容量、消費電力、寸法が巨大化する等の課題は生じない。また、静電偏向器30は、磁場を用いる偏向電磁石に比べて、軽量化、低消費電力化および低コスト化が可能である。

【0089】

上記のように、このイオンビーム装置によれば、一つの静電偏向器30によって、イオンビーム4の平行化とエネルギー分離の両方を行うことができるので、両者を特許文献1または2に記載の技術のように別々の機能要素によって行う場合に比べて、イオンビーム4のビームライン長を短くすることができる。

【0090】

更に、上記のように静電偏向器30におけるエネルギー分離機能は極めて大きいので、特許文献3に記載の技術に比べて、静電偏向器30の出口からターゲット50までの距離を大幅に短くすることができる。従ってこの観点からも、イオンビーム4のビームライン長を短くすることができる。

【0091】

なお、特許文献1に記載の技術では、エネルギー分離性能を高めるために、静電偏向器の出口から相当離れた位置に、所望エネルギーのイオンビームを通し不所望エネルギーのイオンを阻止するビームマスクを設けている。これに対して、このイオンビーム装置では、上記と同じ目的および同じ作用のビームマスクを設ける場合でも、それを、静電偏向器30の出口付近に設けることが可能である。図1に示すビームマスク46はその一例を示す。これは、前述したように、静電偏向器30におけるエネルギー分離機能が極めて大きいからである。従って、ビームマスク46を設ける場合でも、静電偏向器30からビームマスク46までの距離を極めて短くすることができるので、やはり、ビームライン長を短くすることができる。

【0092】

また、このイオンビーム装置によれば、図5を参照して、前記走査中心Pから静電偏向器30の入口までの距離 L_1 を比較的小さくすることが可能である。その比較対象として、1992年に発行された次の文献に記載されている、静電的にイオンビームの平行化を行う技術が挙げられる。

【0093】

イオン注入技術-92 (ION IMPLANTATION TECHNOLOGY-92), エイ・エム・レイ他 (A. M. Ray et al.), イートンNV-8200Pの概観 (Overview of the Eaton NV-8200P), p. 401-404

【0094】

上記文献に記載の技術では、走査されたイオンビームの平行化のための電極の入口において、イオンビームの走査幅が、イオン注入すべきターゲットの直径に相当する値となつていなければならない。これに対して、この発明に係るイオンビーム装置では、イオンビーム4の平行化等のための静電偏向器30の出口において、イオンビーム4aの走査幅がターゲット50の直径に相当する値であれば良いことから、イオンビームの走査角度を同じ条件として両技術を比較すれば、上記文献に記載の技術よりも、この発明に係るイオンビーム装置の方が、上記距離 L_1 を短くできることは明らかである。

【0095】

この発明に係るイオンビーム装置では、図5を参照して、前記走査中心Pから静電偏向器30の出口Qまでのビームライン長 L_P は、走査器12における走査角度を $\pm\theta$ 、静電偏向器30における実効的な偏向半径をR、ターゲット50の直径をDとすると、次式で表される。なお、図5は、図1の走査器12と静電偏向器30とを抽出して拡大して示すものである。

【0096】

[数3]

$$\begin{aligned} L_P &= L_1 + \pi R / 2 \\ &= L_2 - R + \pi R / 2 \\ &= D / (2 \tan \theta) - R + \pi R / 2 \\ &= D / (2 \tan \theta) + (\pi / 2 - 1) R \end{aligned}$$

【0097】

上記式より、 $D = 300\text{ mm}$ 、 $\theta = \pm 15^\circ$ 、 $R = 400\text{ mm}$ を例としてビームライン長 L_P を求めるとき、 $L_P \approx 788\text{ mm}$ となる。

【0098】

以上のように、いずれの公知技術と比較しても、このイオンビーム装置によれば、イオンビーム4のビームライン長を短くすることができる。その結果、例えば、イオンビーム4の発散等による損失を低減してビーム輸送効率の向上を図り、大きなビーム量を確保することができる。この効果は、特に低エネルギーのイオンビーム4を輸送する場合に顕著になる。

【0099】

また、ビームライン長を短くすることができるので、装置全体をコンパクトにすることができる。

【0100】

また、走査器12以降では、イオンビーム4の走査角度方向の対称性が維持されているので、走査器12以降の機器構成が容易である。かつ、イオンビーム4の特性が走査角度方向について均一である。前者の理由は、対称性を有する機器は、その設計、加工、配置等が容易だからである。後者の利点は、例えばスポット状のイオンビーム4の断面形状等が走査角度方向によって変化しないことである。

【0101】

静電偏向器30を出たイオンビーム4aの、その進行方向に垂直な走査ビーム断面5の形状は、即ちY-Z平面での走査ビーム断面5の形状は、図2、図6、図14に示すよう

に、弧状をしている。より具体的には、前記走査中心PをY-Z平面に平行な面上に投影した点P₁（図14参照）を中心とする円弧状をしている。なお、上記各図において、走査された1本1本のイオンビーム4aのスポット状の断面の幾つかを小円で示しており、走査されたイオンビーム4aの全体の断面が走査ビーム断面5である。

【0102】

従って、上記ビームマスク46を設ける場合、そのビーム通過穴48の形状は、図6中に実線で示す例のように、弧状（例えば円弧状）の走査ビーム断面5に相似形またはほぼ相似形にするのが好ましい。また、走査ビーム断面5より幾分大きめにするのが好ましい。そのようにすると、静電偏向器30とビームマスク46とが協働して、エネルギー分離性能をより一層高めることができる。更に、イオン注入時のターゲット50からの脱ガス（アウトガス）の影響（真空度悪化）が静電偏向器30に及ぶのをより効率良く抑制して、偏向電極32間で放電が発生して静電偏向器30の動作が不安定になることをより効率良く防止することもできる。

【0103】

もっとも、前述したように静電偏向器30におけるエネルギー分離性能は極めて高いので、ビームマスク46に設けるビーム通過穴48の形状は、図6中に二点鎖線で示すように、弧状の走査ビーム断面5を包含する長方形にしても良い。そのようにすると、ビーム通過穴48の形状が単純になる。

【0104】

静電偏向器30内は、即ちその偏向領域34は、イオンビーム4、4aが雰囲気中の分子、粒子と衝突することや前記放電発生を避ける等のために、高真空に維持しておくのが好ましいので、この偏向領域34の真空排気を十分に行える真空排気装置を設けるのが好ましい。この偏向領域34の真空排気は、図3中に矢印80または82で示すように、イオンビーム4aの進行方向とは直角の方向に行うのが好ましい。そのようにすると、偏向領域34が前記のように曲がっていても、その曲がりが排気のコンダクタンス低下を招くことが少ないので、偏向領域34を効率良く真空排気することができる。

【0105】

前記静電偏向器30に課せられる条件は、その一対の偏向電極32の相対向面33が前述したようにイオンビーム4の走査角度方向についての対称性を持つことと、90度偏向であるということのみであり、それ故に、これらの条件を満足しておれば、両偏向電極32の、より具体的にはその相対向面33の形状は、前述した例のもの以外に、イオンビーム4aの進行方向に沿って分割したり、複数の曲面を組み合わせて構成したり、複数の平面と曲面とを組み合わせて構成する等しても良い。

【0106】

例えば、図7は、図1～図3に示した両偏向電極32を、それぞれ、偏向角の増大方向に隙間70をあけて2分割した例である。これよりも多く分割しても良い。また、一方の偏向電極32のみを分割しても良い。このようにすると、当該隙間70から、矢印84または86に示すように、静電偏向器30内を、即ちその偏向領域34を効率良く真空排気することができる。これは、偏向領域34が前記のように曲がっていても、その曲がりが排気のコンダクタンス低下を招くことが少ないのである。

【0107】

図8は、両偏向電極32の相対向面33の断面形状を楕円にした例である。この例では、Z軸に沿う方向に長軸を有する楕円であるが、X軸に沿う方向に長軸を有する楕円でも良い。

【0108】

図9は、両偏向電極32を、それぞれ、複数の（図示例では三つの）偏向電極片32aを組み合わせて（接続して）構成した例である。即ち、両偏向電極32の相対向面33を、図3に示したのと同じ軸60を中心とする前記回転面に概ね沿う複数の（図示例では三つの）面を組み合わせて（接続して）形成した例である。その断面はほぼ図10に示すようなものである。各偏向電極片32aおよびその相対向面33は、上記軸60を中心軸と

する円錐の一部分から成る。

【0109】

上記いずれの例においても、両偏向電極32の少なくとも相対向面33は、それぞれ、カーボン、シリコン、アルミニウムまたはこれらの化合物で形成するのが好ましい。例えば、両偏向電極32自体をこれらの材質で形成しても良いし、両偏向電極32の相対向面33にこれらの材質の膜を被覆しても良い。

【0110】

両相対向面33は、不所望エネルギーのイオン4b（図1参照）が衝突してスパッタされる可能性がある。即ち、当該相対向面33からそれを構成する物質を含むスパッタ粒子が叩き出される可能性がある。そこで、相対向面33を上記のような材質で形成しておくと、このスパッタ粒子が万ターゲット50に到達しても、ターゲット50の表面に作成される半導体デバイスの特性に与える影響が少ない。

【0111】

ところで、前記数2から明らかなように、静電偏向器30におけるイオンビーム4の偏向角度はイオンビーム4を構成するイオンの質量mに依存しないので、質量mが異なっていても、 q/E_B (E_B はエネルギー、qは電荷) が同じ値を持つイオンは同じ軌道を描く。通常は、質量mの異なるイオンについては、走査器12に入るまでに質量分離電磁石6を通過させて所望の質量mのみのイオンから成るイオンビーム4を得るのであるが、ときにより例えば水素原子を多く含むイオンや、同位体を持つイオンをターゲット50に注入する場合があり、その場合には、質量mがわずかに異なる有用な（即ち所望の）イオンが複数種類イオンビーム4中に存在することになる。

【0112】

このようなイオンは、例えば、 $B_2H_x^+$ ($x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$)、 $B_{10}H_y^+$ ($y = 1, 2, \dots, 14$)、 Sb_z^+ ($z = 121, 123$) である。

【0113】

このようなイオンを用いて、できるだけ大きなイオンビーム量で注入を行いたい場合は、質量分離電磁石6の質量分解能を意図的に低下させることによって、上記のようなイオンを取り出して走査器12に入射させることができる。そして、静電走査型の走査器12および上記静電偏向器30を通して取り出して、ターゲット50に対してイオン注入を行うイオンビーム4aとして使用することが可能となる。これは、前述したように、静電走査や静電偏向では、これら質量mの異なるイオンであっても、その軌道は質量mの違いによって異なることはなく、ターゲット50の位置でのビーム走査領域やターゲット50への入射角度について、全て同様に注入されるからである。

【0114】

イオンビームの偏向を磁場によって行う場合は、例えば特許文献2および3に記載されているイオンビームの平行化のための偏向電磁石では、ターゲット上でのイオンビームの走査位置や注入角度は、イオンの質量mに依存してそれが異なる上記各イオンについては異なる値となるため、注入量や入射角度の不均一性がターゲット50の面内で発生することになり、イオン注入によって形成される半導体デバイスの特性にはらつきや劣化の問題が生じる可能性を否定できない。

【0115】

もっとも、走査器12に関しては、質量がわずかに異なるイオンの上記のような利用によることを抜きにすれば、あるいは適当な走査幅を設定すること等を行えば、磁界制限があることを抜きにすれば、磁界走査型の走査器12を用いても良い。

【0116】

次に、以下における説明の準備のために、ターゲット50の表面に入射するイオンビーム4aの入射角度、即ち注入角について説明すると、これには二種類ある。これを図11を参照して説明すると、図示例は第1の注入角 ϕ （ファイ）および第2の注入角 ψ （プサイ）は共に0度の場合である。ターゲット50の表面に立てた垂線64を考えると、イオンビーム4aの走査方向と直交する方向におけるイオンビーム4aと垂線64との成す角

が第1の注入角 ϕ である。イオンビーム4aはY軸に沿う方向に走査されるから、Y軸に平行な軸66を中心軸にして、ターゲット50またはイオンビーム4aを相対的に回転させると、注入角 ϕ は変化する。垂線64aは、注入角 ϕ が0度でない場合の例である。

【0117】

イオンビーム4aの走査方向におけるイオンビーム4aと垂線64との成す角が第2の注入角 ϕ である。Y軸に直交するZ軸に平行な軸68を中心軸にして、ターゲット50またはイオンビーム4aを相対的に回転させると、注入角 ϕ は変化する。垂線64bは、注入角 ϕ が0度でない場合の例である。

【0118】

さて、静電偏向器30とターゲット50との間には、図1に示す実施形態のように、イオンビーム4aを磁場44によって偏向させる偏向電磁石42を設けても良い。この偏向電磁石42は、イオンビーム4aの経路を挟んで相対向する磁極を有している。その磁場44の向かう方向に見た平面の例を図12および図13にそれぞれ示す。

【0119】

この偏向電磁石42の入口端では、イオンビーム4aは既に平行化されていて、X-Y平面にはほぼ沿うほぼシート状のイオンビームになっているので、この偏向電磁石42によるイオンビーム4aの偏向は、このシート面とほぼ同一の面内で行われ、かつ、走査された各イオンビーム4aについて全て同じ角度で偏向が行われるようにするのが好ましい。このような偏向電磁石42の磁極面の形状は、概ね長方形となる。

【0120】

このような偏向電磁石42を設けることによって、例えば、(a) 第2の注入角 ϕ の調整(図12参照)、(b) イオンビーム4aの走査幅Wの拡大(図13参照)または縮小(図12参照)のための調整、(c) ターゲット50の近傍と静電偏向器30との間でイオンビーム4a中の電子やイオンビーム4a以外のイオンの移動を防止すること、等を行うことができる。

【0121】

上記(a)の注入角 ϕ の調整に関して説明すると、例えば、このイオンビーム装置の機械的組立精度が不十分で、ターゲット50が元々正しく方位されていない状態に組み立てられているような場合、偏向電磁石42によってこの注入角 ϕ を調整して基準値(通常は0度)に合わせることを簡単に行うことができる。

【0122】

上記(b)の走査幅Wの調整に関して説明すると、偏向電磁石42の配置および偏向電磁石42でのイオンビーム4aの偏向角度を適度に取ることによって、入射イオンビーム4aの走査幅をW₁、出射イオンビーム4aの走査幅をW₂としたとき、図13に示す例のようにW₁ < W₂に拡大することもできるし、図12に示す例のようにW₁ > W₂に縮小することもできる。走査幅Wを拡大する場合を例に取ると、ターゲット50の寸法の拡大への対応に際して、この偏向電磁石42以外の部分に変更を加えることなく、容易に対応することができる。

【0123】

上記(c)の作用に関して説明すると、仮に、ターゲット50と静電偏向器30との間で電子やイオンビーム4a以外のイオンの移動があると、イオンビーム4aのビーム量の計測に誤差を生じたり、ターゲット50への金属コンタミネーションの増大やパーティクルの付着等の不具合が生じるけれども、上記電子やイオンのエネルギーはイオンビーム4aに比べて十分に小さいので、偏向電磁石42による小さな偏向磁場強度で上記電子やイオンを大きく偏向させてイオンビーム4aから大きく分離することができるので、上記不具合発生を防止することができる。

【0124】

静電偏向器30を出た走査されたイオンビーム4aの全体の走査ビーム断面5は、前述したように、円弧状をしている。例えば図14参照。この走査ビーム断面5に対して、ターゲット50を、その円弧の中心P₁から半径方向に機械的に往復走査(往復運動)させ

ることによって、ターゲット50をイオンビーム4aに対して横切らせて（交差させて）、ターゲットの全面にイオンビーム4aを照射してイオン注入を行うことができる。なお、図14は、静電偏向器30から出射するイオンビーム4aを図2と同じ方向から見て示すものである。

【0125】

図14では、イオンビーム4aは紙面（即ち、Y-Z平面に平行な面）に垂直に表方向に出射しており、ターゲット50に垂直にイオンビーム4aを入射させる場合（即ち前記注入角 ϕ および ψ が共に0度の場合）であり、従ってターゲット50の表面は紙面に平行であり、かつターゲット50の往復走査の方向も紙面に平行の場合の例を示すものであるが、ターゲット50の往復走査の方向とイオンビーム4aの走査方向との関係は以下のとおりである。

【0126】

即ち、ターゲット50の中心が、円弧状の走査ビーム断面5の円弧の中心P₁を通りかつZ軸に平行な直線72上を往復運動するようにターゲット50を往復走査するのであって、しかもこの往復走査によって、直径Dのターゲット50が、走査ビーム断面5のY軸に平行な方向の走査幅W_Sをはみ出さないように往復走査する。その機械的な走査幅をW_Mとする。上記中心P₁から走査ビーム断面5の中心までの半径をL₂とする。この半径L₂は、図5に示した距離L₂と同じである。

【0127】

図14の構成において、ターゲット50の面内に均一にイオン注入を行う条件を考察する。イオンビーム4aが走査角度 θ のときのY軸に平行な方向のイオンビーム4aの位置（即ち直線72からの距離）は、L₂sinθである。従って、Y軸に平行な方向のイオンビーム4aの移動速度v_yは次式で表される。

【0128】

[数4]

$$\begin{aligned} v_y &= L_2 \cdot \cos \theta \cdot d\theta / dt \\ &= L_2 \cdot \cos \theta \cdot \omega, \quad (\omega \text{ はイオンビーム走査の角速度}) \end{aligned}$$

【0129】

平行平板型の走査電極による静電走査の場合には（図1および図2に示す走査器12もそうである）、その走査電圧を時間的に一定の増加率で走査するとき、そのイオンビームの走査幅yは次式で表され、時間tに比例する。

【0130】

[数5]

$$y = k \cdot t \tan \theta \quad (t) = a t, \quad (k, a \text{ は定数}, t \text{ は時間})$$

【0131】

従って、平行平板型の走査電極のみによる走査されたイオンビームのY軸に平行な方向の移動速度v_yは、 $v_y = dy / dt = a$ （一定）となる。これと上記数5とから次式が得られる。

【0132】

[数6]

$$k \cdot \sec^2 \theta \quad (t) \cdot \omega = dy / dt = a \quad (\text{一定})$$

【0133】

この数6と上記数4とを用いて、静電偏向器30を出た後のイオンビーム4aのY軸に平行な方向の移動速度v_yを、次式のように表すことができる。

【0134】

[数7]

$$v_y = L_2 \cdot \cos^3 \theta \quad (t) \cdot a / k$$

【0135】

この数7で表される移動速度v_yは、時間的に一定の値ではない。即ち、 $\tan \theta$ が時間比例のときは、Y軸に平行な方向のイオンビーム4aの位置は時間比例とはならず、Y

軸に平行な方向のイオンビーム4aの移動速度 v_y は一定にならぬのである。逆に、この移動速度 v_y を一定にするには、 $\sin \theta = ct$ (c は定数、 t は時間)とすれば良い。これを $\tan \theta$ で見ると、次式とすれば良い。

【0136】

[数8]

$$\tan \theta = \sin \theta / (1 - \sin^2 \theta)^{1/2} = ct / (1 - c^2 t^2)^{1/2}$$

【0137】

$\tan \theta$ は、図1および図2に示したような平行平板型の走査電極14間に印加する走査電圧 V_s に比例するので、結局、この走査電圧 V_s を次式のように時間変化させれば良いことになる。

【0138】

[数9]

$$V_s = ct / (1 - c^2 t^2)^{1/2}, \quad (c \text{は定数}, t \text{は時間})$$

【0139】

この走査電圧 V_s の時間変化の様子（即ち波形）を図15中に実線92で示す。但し誇張して図示している。参考までに、単なる三角波形を破線94で示す。

【0140】

従って、前記走査電源16から、走査器12を構成する一対の互いに平行な走査電極14間に、上記数9で表される走査電圧 V_s を印加することによって、静電偏向器30を出したイオンビーム4aの走査方向における直線上の走査速度、即ちY軸に平行な方向における走査速度が一定になる。

【0141】

これと、ターゲット50を走査機構54によって、Z軸に平行な方向に一定の走査速度で機械的に往復走査することと併用することによって、ターゲット50の全面において均一なイオン注入量分布を得ることができる。

【0142】

以上は、第1および第2の注入角 ϕ および ψ が0度（即ち垂直ビーム入射）の場合についてであるが、第1の注入角 ϕ が0度でない場合（即ち角度注入の場合）の例を図16に示す。この図は、ターゲット50周りを図1と同じ方向から見て示すものである。この図において、前記走査機構54によって、注入角 ϕ を一定に保ってターゲット50を往復走査するには、（a）ターゲット50を矢印86に示すように、ターゲット50の表面に平行に位置A-B間で往復運動させる場合と、（b）ターゲット50を、矢印88に示すように、Z軸に平行な前記（図14参照）軸72に平行に位置A-C間で往復運動させる場合とがある。この（a）、（b）いずれの方向にターゲット50を走査しても、ターゲット50の表面に対するイオンビーム4aの注入角 ϕ は一定である。

【0143】

上記（a）の場合は、ターゲット50へのイオンビーム4aの入射位置は、イオンビーム4aの進行方向、即ちX軸に平行な方向において、ターゲット50の面内で変化せず一定である。つまり、ターゲット50の全ての面内において、上記軸72から一定の距離 L_4 の位置で入射し、従って、仮にイオンビーム4aの状態（例えば断面寸法）がその進行方向において変化するようなことがあったとしても、イオンビーム4aをターゲット50の全面に同一条件で照射してイオン注入を行うことができる。しかし、ターゲット50の機械的な往復走査幅は、上記（b）の場合よりも $1/cos\phi$ だけ大きくなる。

【0144】

一方、上記（b）の場合は、ターゲット50へのイオンビーム4aの入射位置は、X軸に平行な方向において、ターゲット50の面内で変化する。即ち、ターゲット50が位置AからCへ走査された場合を考えると、イオンビーム4aは、ターゲット50の表面の一端部50aから中央部50bを経て他端部50cへと照射され、ターゲット50の面内において距離 L_3 だけ変化（前後）する。従って、上記（a）の場合とは長所と短所とが逆になる。

【0145】

しかし、(a)、(b)いずれの場合でも、ターゲット50の面内における良好な注入均一性を確保するために必要な走査電圧Vsの時間変化は、前記数9に基づいて達成することができる。

【0146】

このイオンビーム照射装置において、ターゲット50に対する注入均一性の測定と、その測定情報に基づくイオンビーム4の走査波形等の整形手法については、例えば、特許第2969788号公報に記載されている技術を利用することができる。

【0147】

これを図1を参照して簡単に説明すると、ターゲット50を保持するホルダ52の上流側および下流側に、Y軸に沿う方向に走査されたイオンビーム4aを受けることのできる、走査方向に（即ちY軸に沿う方向に）多点の多点ファラデー列56および58をそれぞれ設けておく。下流側の多点ファラデー列58はイオンビーム4aのビームライン上に固定しておいても良いが、上流側の多点ファラデー列56は、矢印78に示すように移動させて、測定時にのみイオンビーム4aのビームライン上に移動させる。

【0148】

上記二つの多点ファラデー列56および58から得られる、走査されたイオンビーム4aの走査方向のビーム電流量（ビーム電流の時間積分値）の分布やビームの平行性についての情報に基づいて、それらが良好なものとなるように、走査器12に供給する走査電圧Vsの波形や静電偏向器30に供給する偏向電圧V_Dの大きさの調整を行えば良い。即ち、ビーム電流量が他よりも多い所では、その位置に対応する部分の走査電圧Vsをゆっくり変化させ、他よりも少ない所では速く変化させるようにすれば良い。

【0149】

ターゲット50に入射するイオンビーム4aの平行性については、図17を参照して、偏向電圧V_Dが適切なときは同図(A)に示すようにX軸に平行な平行ビームとなり、偏向電圧V_Dが不足して偏向角度が90度よりも小さいときは同図(B)に示すようにX軸に平行よりも広がったビームとなり、偏向電圧V_Dが過大で偏向角度が90度よりも大きいときは同図(C)に示すようにX軸に平行よりも狭まったビームとなる。従って、上記二つの多点ファラデー列56および58からの情報に基づいて、図17(B)または(C)の状態になっていることが測定されたら、その各々の程度に応じて偏向電圧V_Dを大きくしたり小さくしたりすれば良い。

【0150】

この発明に係るイオンビーム装置（より具体的にはイオン注入装置）の仕様の一例を示すと次のとおりである。

【0151】

X-Z平面の方向：水平

Y-Z平面の方向：垂直

走査器12へのイオンビームの入射方向：Z軸に平行

ターゲット50に入射するイオンビーム4aのエネルギー：1keV～300keV

イオンビーム4aを構成するイオンの質量m：10AMU～250AMU

イオン源2からのイオンビーム4の引出し電圧：10kV～50kV

質量分離電磁石6：設置している。

分析スリット10：走査器12のすぐ上流側に設置。そのスリット幅を可変にして、質量分解能の調整が可能（質量分解能の可変範囲は、m/Δm=10～100）。

静電型の走査器12に印加する走査電圧Vs：最大で±20kV

同走査器12での走査角度θ：最大で±20度

加減速器22：設置している。

加減速電圧V_A：0～250kV

偏向電圧±V_D：最大で±100kV

静電偏向器30の偏向電極32の材質：カーボン

偏向電極 32 の相対向面の 33 の形状：トーラス面の一部

静電偏向器 30 での偏向半径 R：最大で 1000 mm

距離 L₁ (図 5 参照)：最大で 1000 mm

静電偏向器 30 出口からターゲット 50 間の距離：最大で 500 mm (偏向電磁石 4

2 を設けない場合)

ビームマスク 46 のビーム通過穴 48 の形状：円弧状

注入時のホルダ 52 の往復走査方向：水平

角度注入：可能。即ち、ホルダ 52 を軸 66 (図 11 参照) の周りに回転させて注入角 ϕ を設定可能。

ホルダ 52 の往復走査方向：ターゲット 50 の表面に平行

多点ファラデー列 56 および 58：設置している。これらからの測定情報に基づいて、走査電圧 V_s および偏向電圧 V_b の調整が可能。

【図面の簡単な説明】

【0152】

【図 1】この発明に係るイオンビーム装置の一実施形態を示す平面図である。

【図 2】図 1 のイオンビーム装置を矢印 F 方向に見て部分的に示す正面図であり、イオン源から静電偏向器の出口までを示す。

【図 3】図 1 中の静電偏向器周りの一例を示す斜視図である。

【図 4】トーラスの一例を示す斜視図である。

【図 5】図 1 中の走査器と静電偏向器との位置関係を示す図である。

【図 6】図 1 中のビームマスクの一例を示す正面図である。

【図 7】静電偏向器の他の例を示す断面図である。

【図 8】静電偏向器の更に他の例を示す断面図である。

【図 9】静電偏向器の更に他の例を示す斜視図である。

【図 10】図 9 の静電偏向器に似た静電偏向器の例を示す断面図である。

【図 11】ターゲットに対するイオンビームの第 1 および第 2 の注入角を示す斜視図である。

【図 12】図 1 中の偏向電磁石の一例を磁場 44 方向に見て示す図である。

【図 13】図 1 中の偏向電磁石の他の例を磁場 44 方向に見て示す図である。

【図 14】静電偏向器を出たイオンビームの弧状の走査ビーム断面とターゲットの動きの相対関係の一例を示す図である。

【図 15】走査電圧波形の一例を示す図である。

【図 16】注入角 ϕ が 0 度でない場合の、静電偏向器を出たイオンビームとターゲットの動きの相対関係の一例を示す図である。

【図 17】ターゲットに入射するイオンビームの例を示す概略図であり、(A) は X 軸に平行な平行ビームを示し、(B) は X 軸に平行よりも広がった例を示し、(C) は X 軸に平行よりも狭まった例を示す。

【符号の説明】

【0153】

2 イオン源

4 イオンビーム

4 a 所望エネルギーのイオンビーム

6 質量分離電磁石

1 2 走査器

1 6 走査電源

2 2 加減速器

2 8 加減速電源

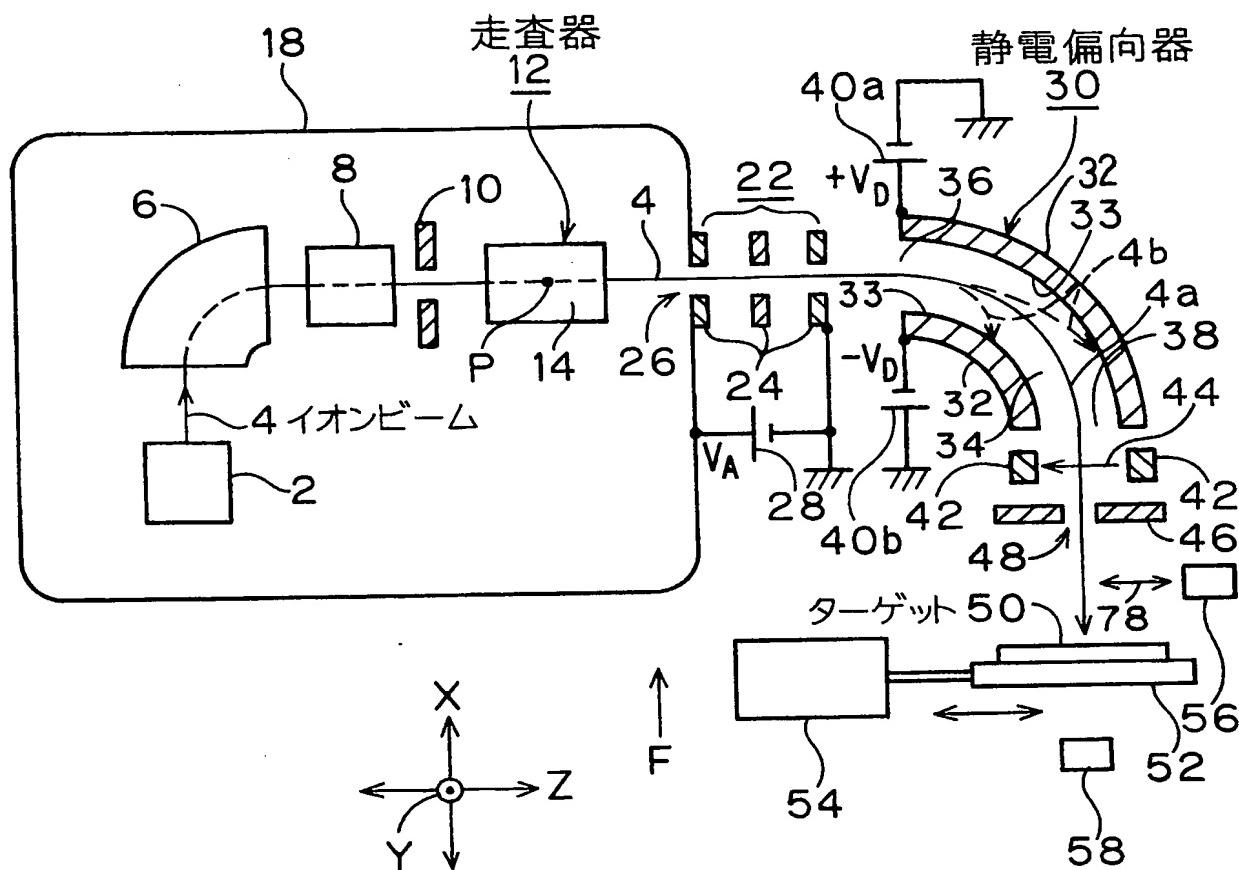
3 0 静電偏向器

3 2 偏向電極

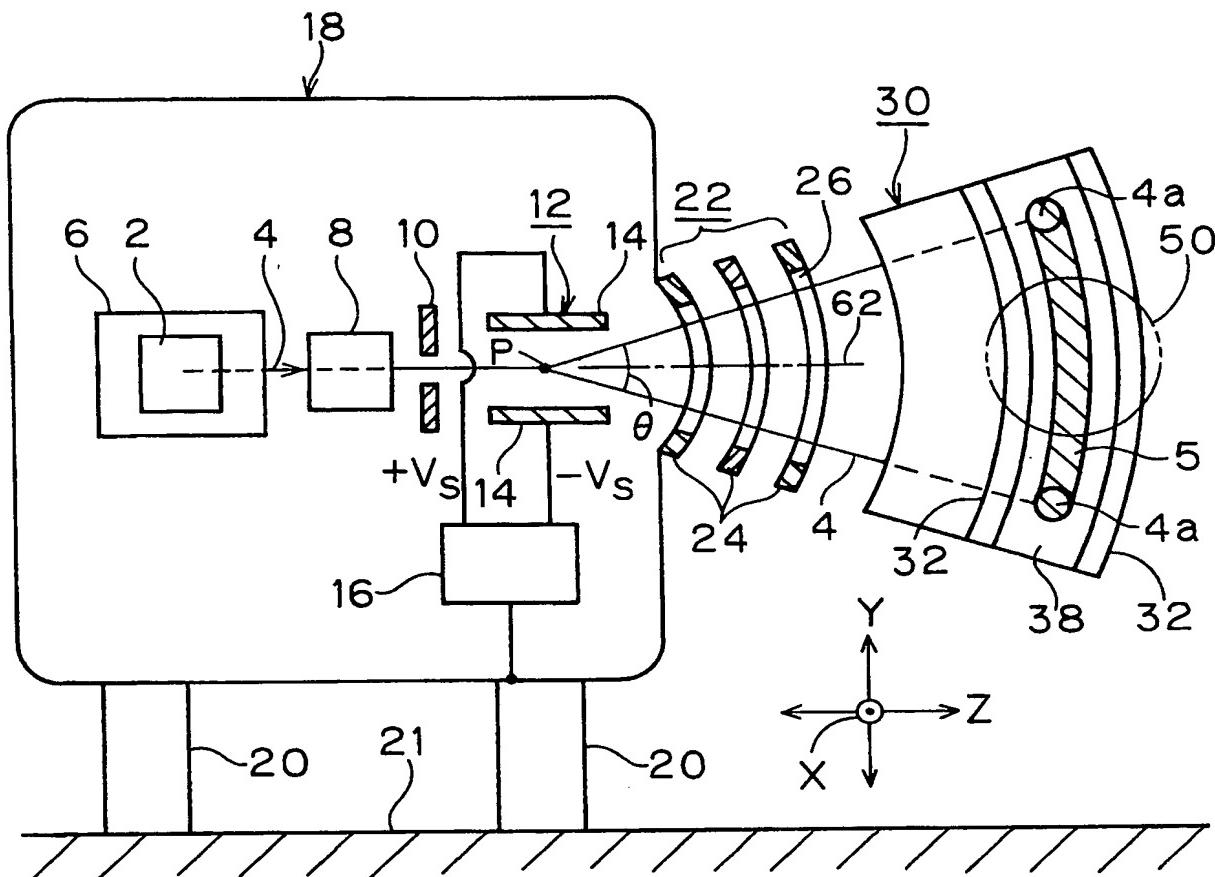
3 3 相対向面

- 40a、40b 偏向電源
- 42 偏向電磁石
- 46 ピームマスク
- 50 ターゲット
- 52 ホルダ
- 54 走査機構

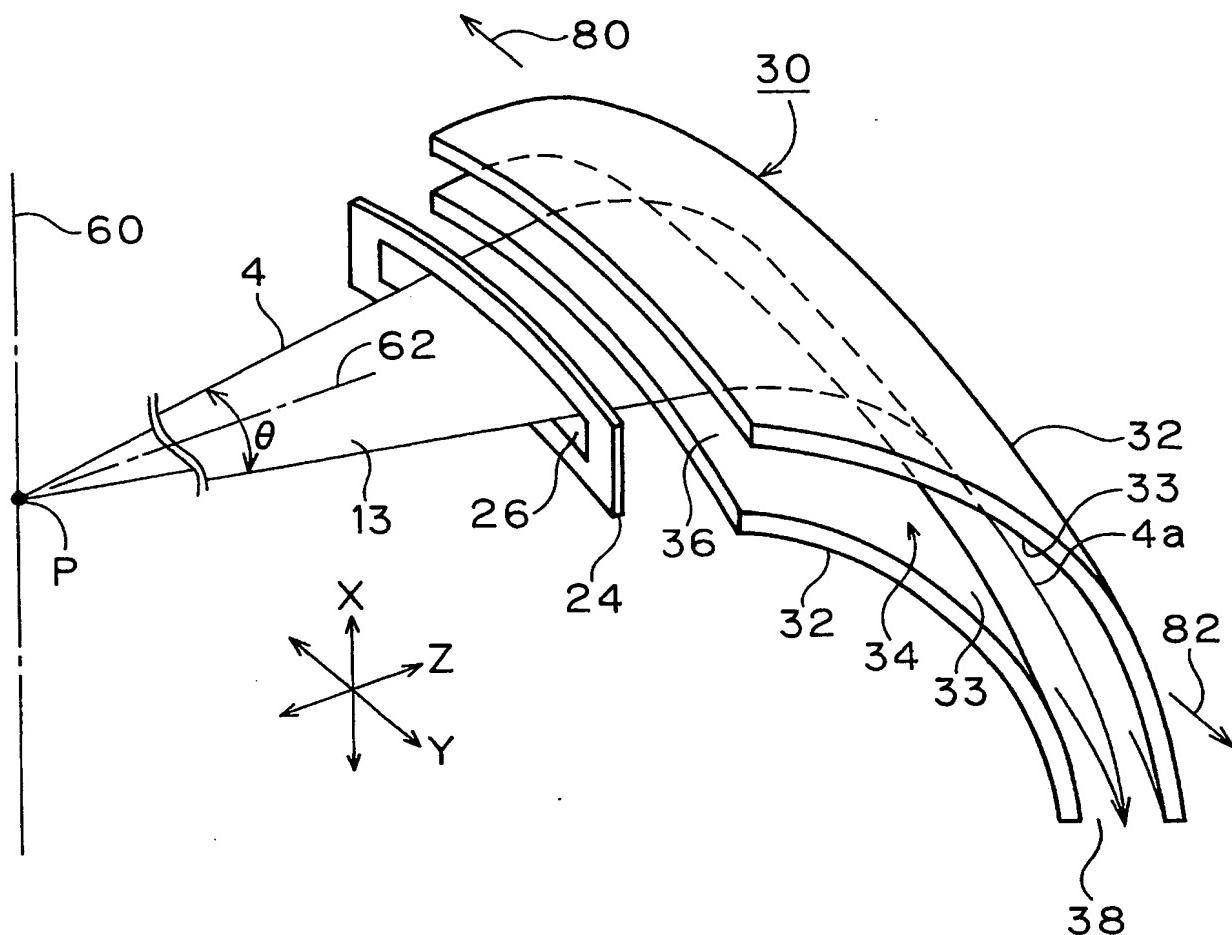
【書類名】図面
【図1】



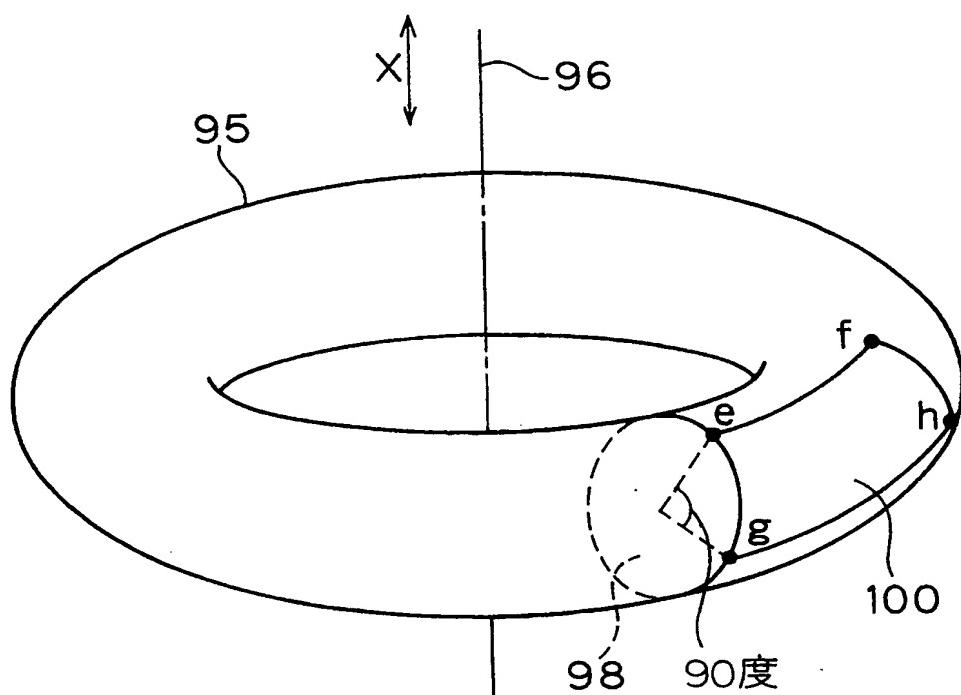
【図2】



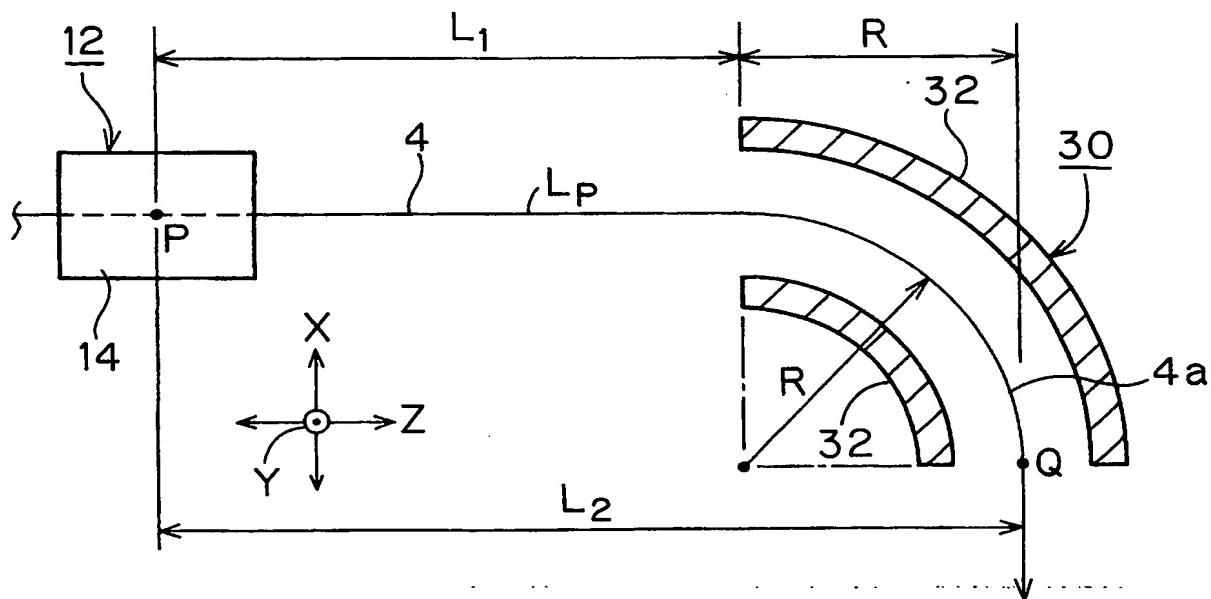
【図3】



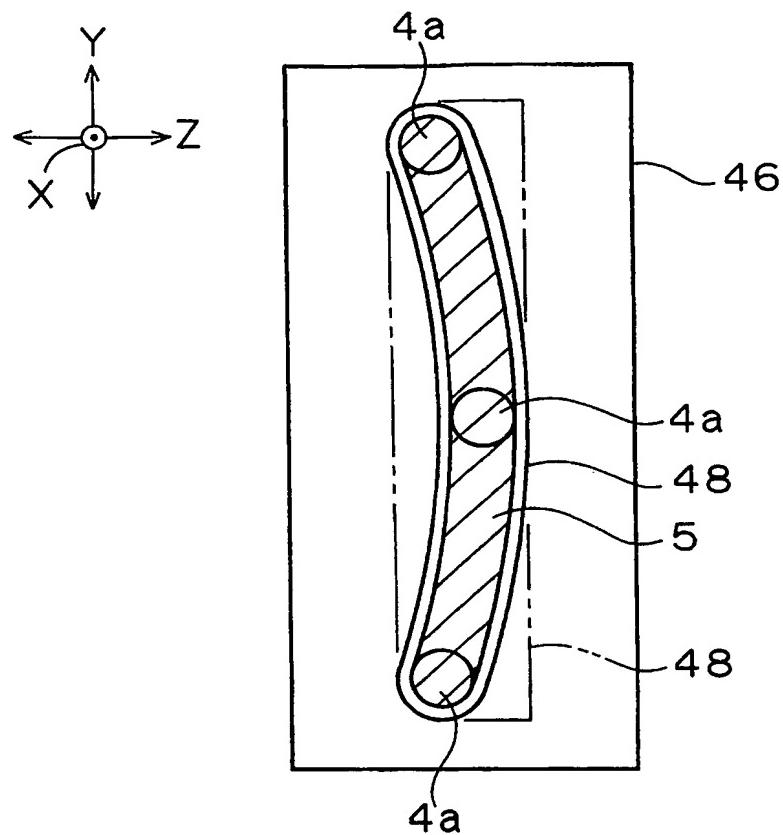
【図4】



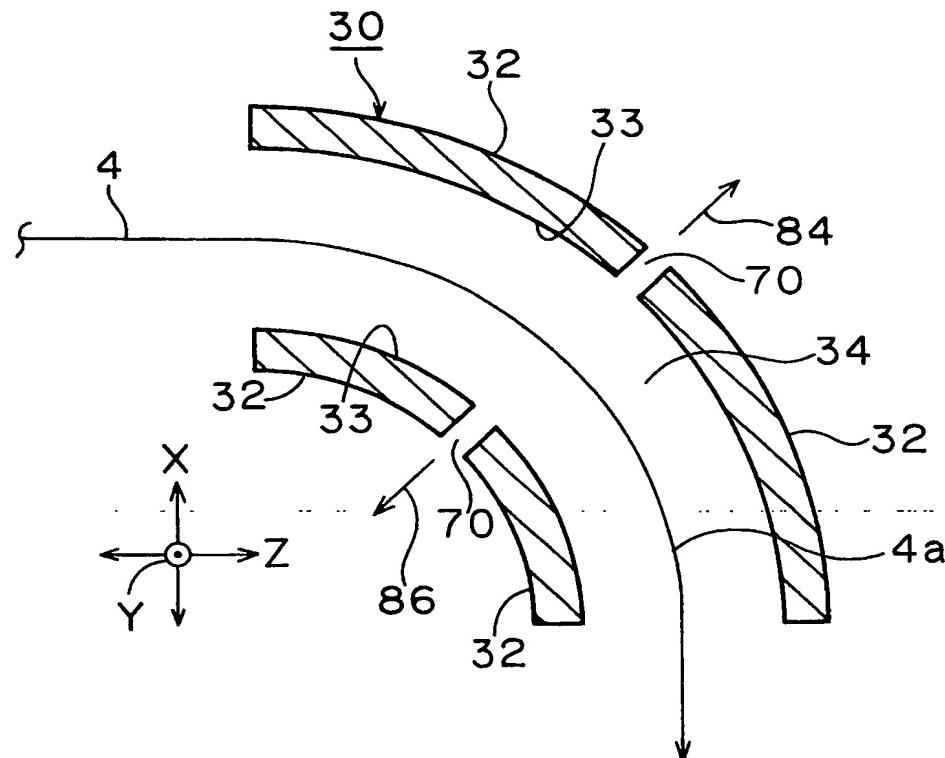
【図5】



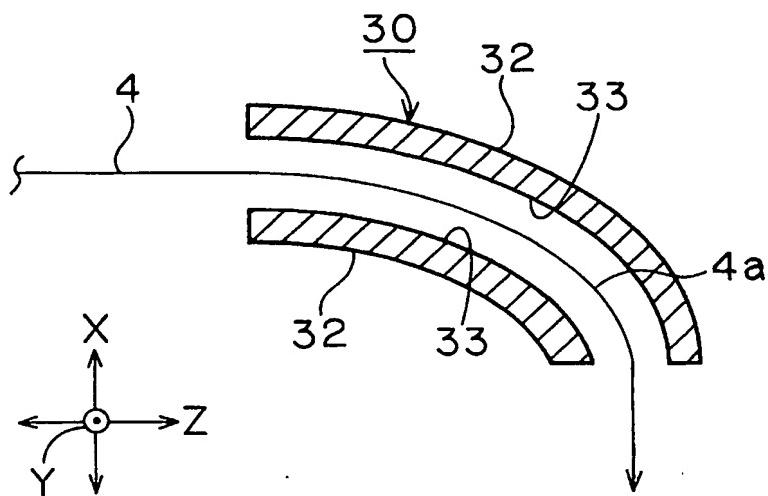
【図6】



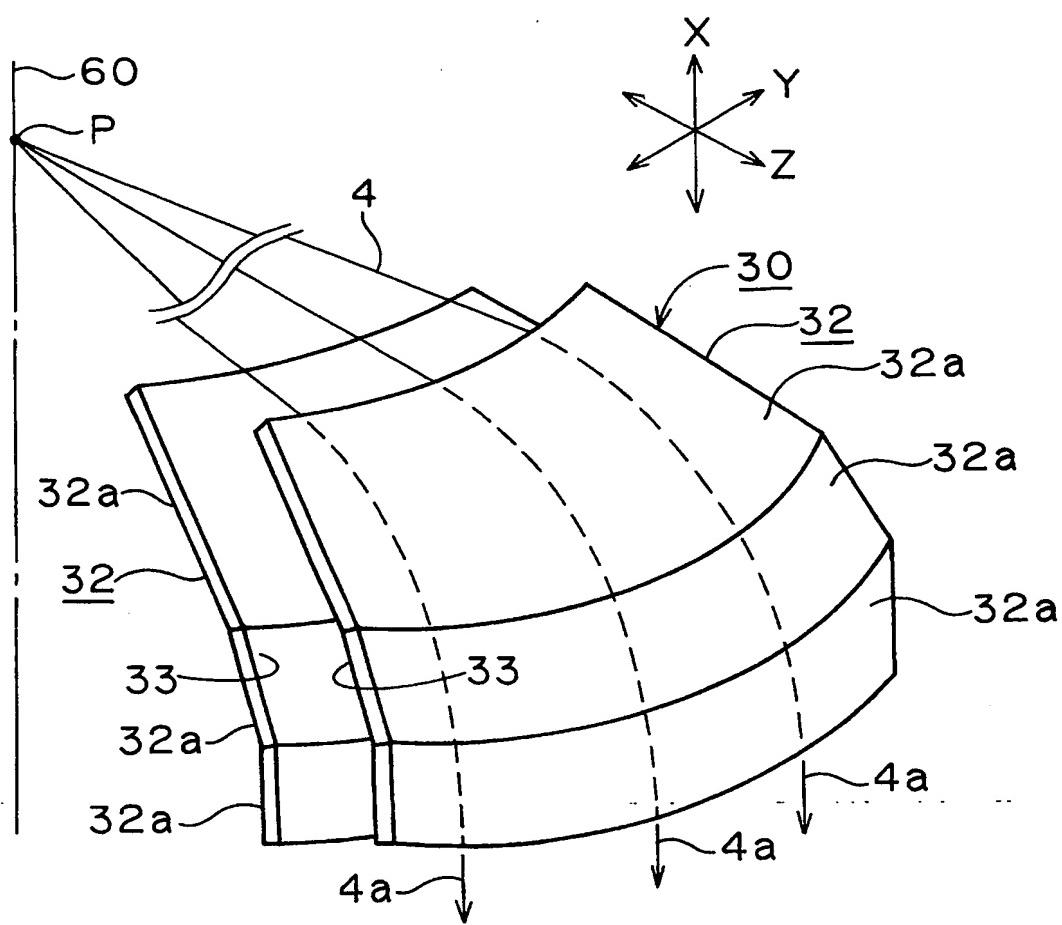
【図7】



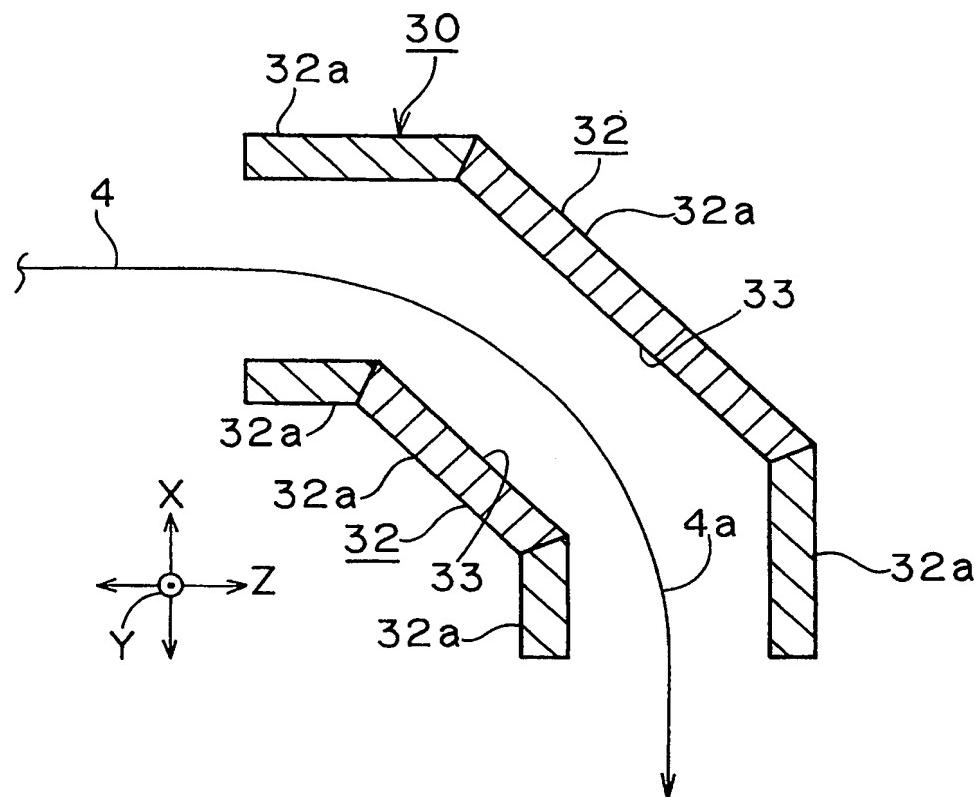
【図8】



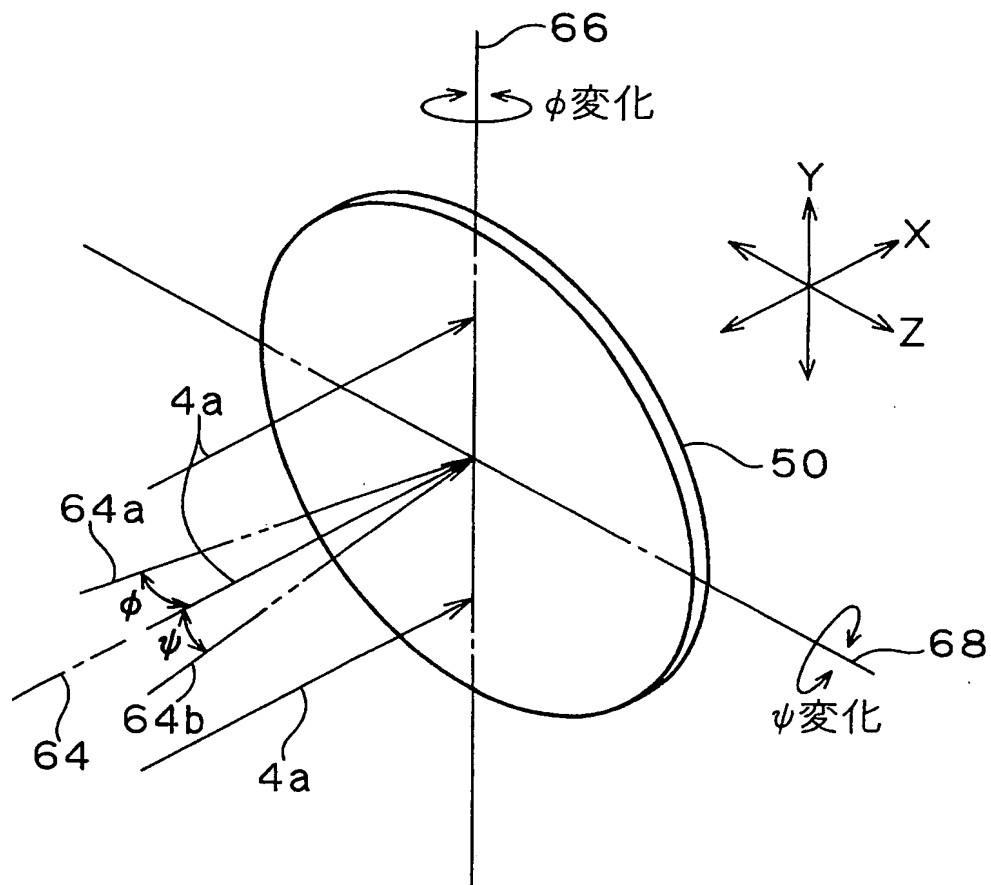
【図9】



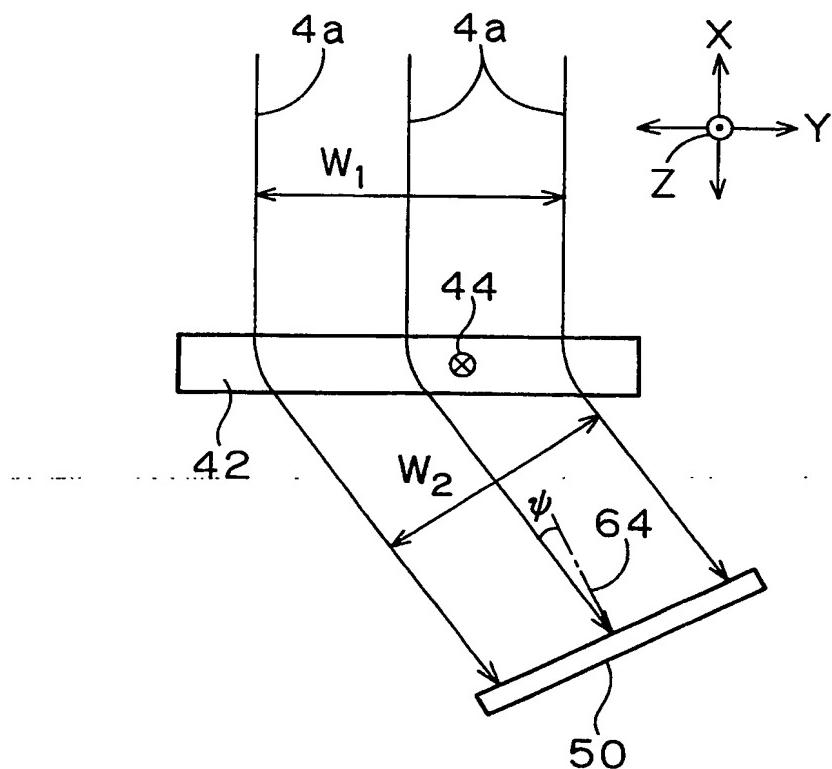
【図10】



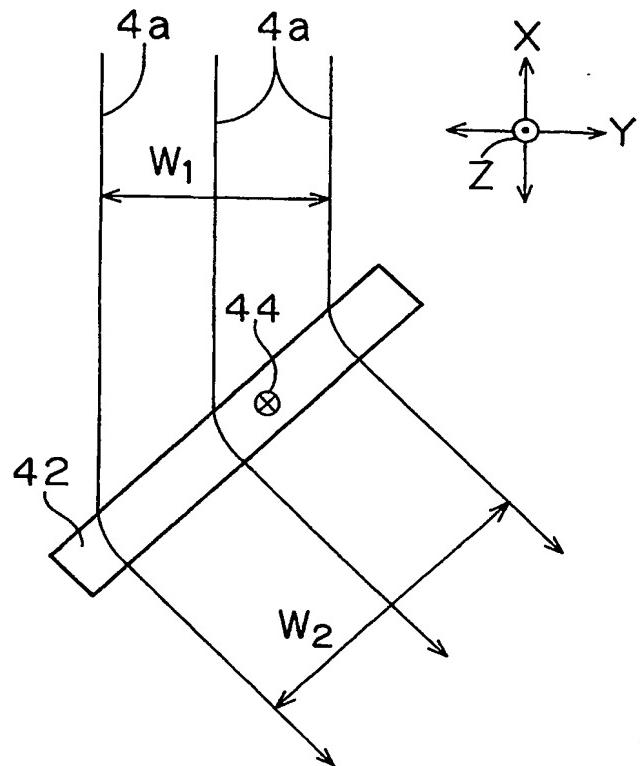
【図 1 1】



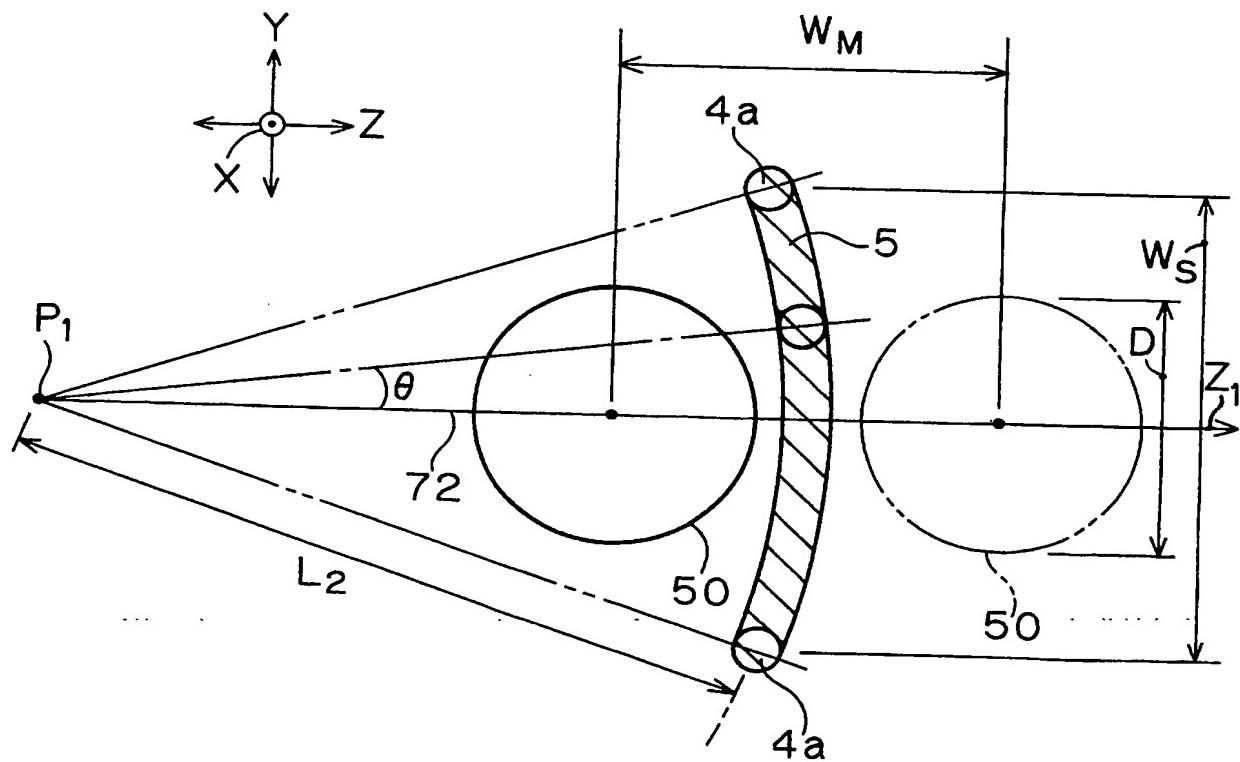
【図 1 2】



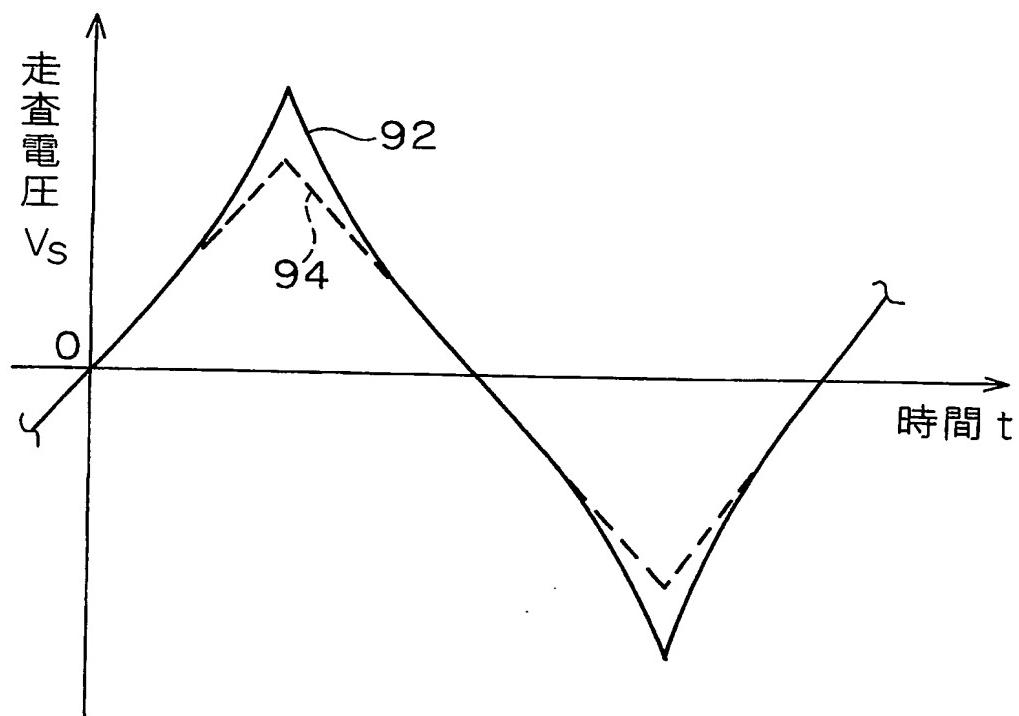
【図13】



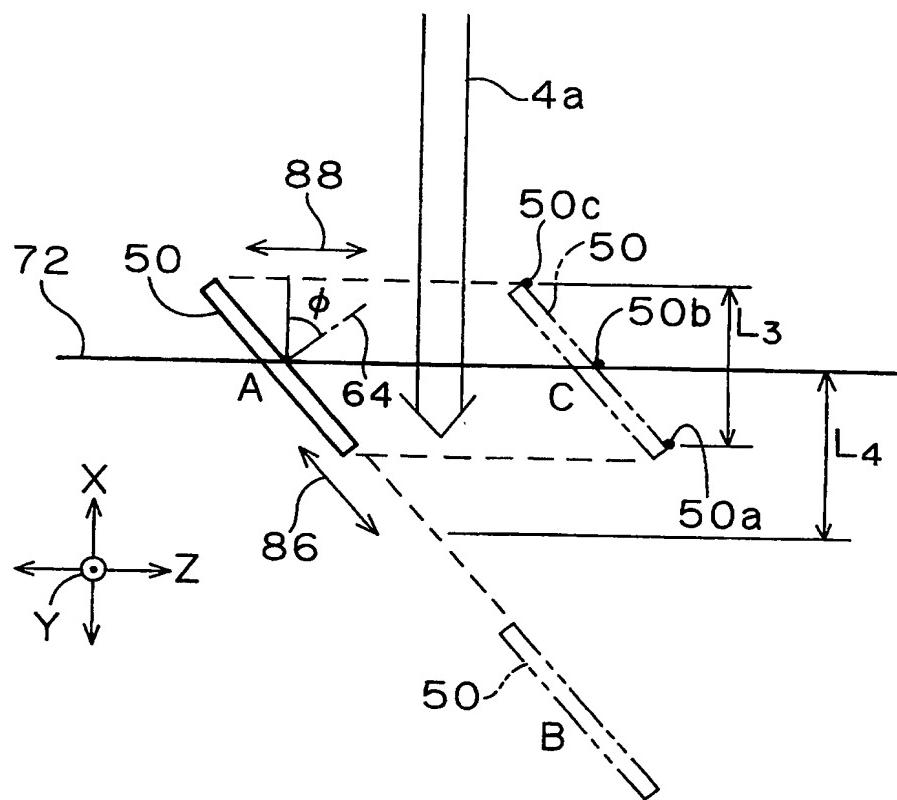
【図14】



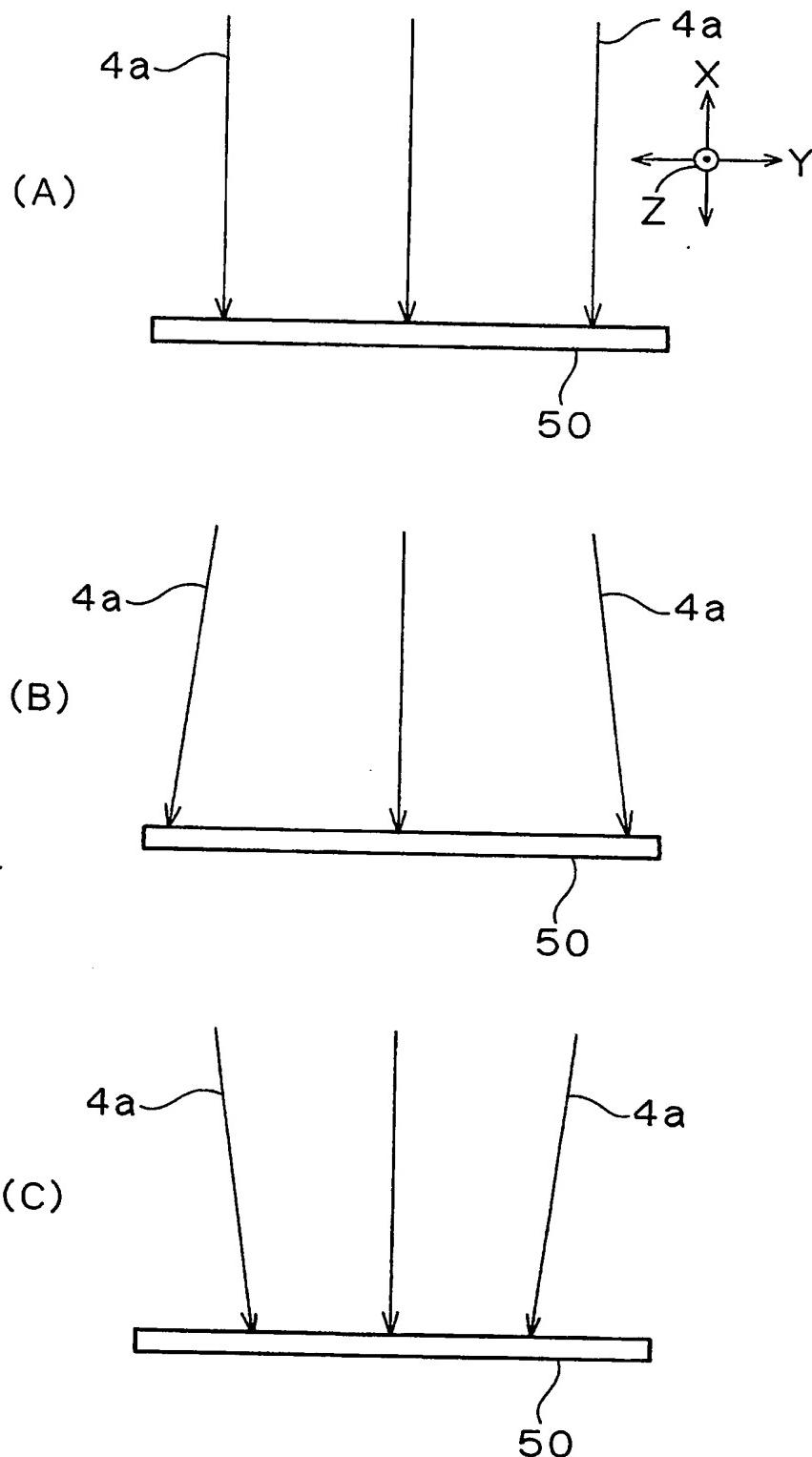
【図 15】



【図 16】



【図17】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 イオンビームの平行化およびエネルギー分離を行うことができ、しかもイオンビームのビームライン長を短くすることを可能にしたイオンビーム装置を提供する。

【解決手段】 このイオンビーム装置は、イオンビーム4を射出するイオン源2と、そのイオンビーム4が入射されてそれから所望質量のイオンビーム4を分離して取り出す質量分離電磁石6と、そのイオンビーム4が入射されてそれを一定の走査面内で一定の走査中心Pを中心にして走査して取り出す走査器12と、そのイオンビーム4が入射されてその内の所望エネルギーのイオンビーム4aを、前記走査中心Pを中心とする円弧状の偏向領域で、前記走査面に垂直な方向に進むように静電的に90度偏向して取り出す静電偏向器30と、ターゲット50を保持してそれを、静電偏向器30から取り出されたイオンビーム4aに一定の角度で交差する方向に機械的に往復走査する走査機構54とを備えている。

【選択図】 図1

特願 2003-405342

出願人履歴情報

識別番号 [302054866]

1. 変更年月日 2002年 9月17日
[変更理由] 新規登録
住 所 京都府京都市南区久世殿城町 575 番地
氏 名 日新イオン機器株式会社

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/018330

International filing date: 02 December 2004 (02.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2003-405342
Filing date: 04 December 2003 (04.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 31 March 2005 (31.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.